I

*(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)*

# VERORDNUNG (EWG) Nr. 1945/86 DES RATES

**vom 18. Juni 1986**

**zur zeitweiligen Aussetzung der autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs für einige industrielle Waren**

DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN –

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 28,

nach Kenntnisnahme von dem Verordnungsentwurf der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Die in dieser Verordnung genannten Waren werden in der Gemeinschaft gegenwärtig nicht oder nur in unzureichender Menge hergestellt. Die Hersteller können somit den Bedarf der verarbeitenden Industrien der Gemeinschaft nicht decken.

Es liegt im Interesse der Gemeinschaft, die autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs in bestimmten Fällen, in denen insbesondere eine Gemeinschaftsproduktion dieser Waren besteht, nur teilweise und in den anderen Fällen vollständig auszusetzen.

Da es schwierig ist, die kurzfristige Entwicklung der wirtschaftlichen Lage auf den betreffenden Gebieten genau zu beurteilen, sollten die Aussetzungen nur zeitweilig erfolgen, wobei ihre Gültigkeitsdauer entsprechend den Interessen der Gemeinschaftsproduktion festzusetzen ist –

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

*Artikel 1*

Die autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs werden für die in den Tabellen im Anhang aufgeführten Waren bis zu der jeweils angegebenen Höhe ausgesetzt.

Diese Aussetzungen gelten

— vom 1. Juli 1986 bis zum 31. Dezember 1986 für die in Tabelle I aufgeführten Waren;

— vom 1. Juli 1986 bis zum 30. Juni 1987 für die in Tabelle II aufgeführten Waren.

*Artikel 2*

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1986 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Geschehen zu Luxemburg am 18. Juni 1986.

*Im Namen des Rates*

*Der Präsident*

N. SMIT-KROES

*ANHANG*

TABELLE I

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 27.13 B II | Synthetisches Paraffin mit einem Molekulargewicht von nicht weniger als 460 und nicht mehr als 1 560 | 0 |
| ex 28.20 A | Aluminiumhydroxidoxid in Form des Pseudo-Böhmits | 4 |
| ex 28.52 B | Lanthanbromidoxid | 0 |
| ex 29.02 A I | Hexafluorpropen | 0 |
| ex 29.02 A III | Dibrommethan | 3 |
| ex 29.03 C I | Äthansulfonylchlorid | 3 |
| ex 29.06 A IV | 3-Äthylphenol | 0 |
| ex 29.08 A III c) und ex 34.02 | Wässerige Lösung mit einem Gehalt an Dinatriumalkyl [oxydi (benzolsulfonat)] von nicht weniger als 30 und nicht mehr als 50 Gewichtshundertteilen | 0 |
| ex 29.09 B | 1,2-Epoxybutan | 0 |
| ex 29.09 B | 1,2-Epoxy-4-(epoxyäthyl)cyclohexan | 0 |
| ex 29.10 B | 8,9-Epoxy-3-(3,4-epoxycyclohexyl)-2,4-dioxaspiro [5,5]undecan | 0 |
| ex 29.14 B I | 2,3-Epoxypropylmethacrylat | 0 |
| ex 29.16 D | 3,4-Epoxycyclohexylmethyl-3,4-epoxycyclohexancarboxylat | 0 |
| ex 29.16 D | Methyl-5-(2,4-dichlorphenoxy)-2-nitrobenzoat | 3,5 |
| ex 29.25 B II c) | Barbitursäure | 0 |
| ex 29.26 A I | 1,2-Benzisothiazol-3-on-1,1-dioxid(*o*-Benzoesäuresulfimid, Saccharin) und sein Natriumsalz | 0 |
| ex 29.31 B | 4,4'-Sulfonyldiphenol mit einem Reinheitsgrad von 99,5 Gewichtshundertteilen oder mehr | 0 |
| ex 29.31 B | Aldicarb (ISO), gelöst in Dichlormethan | 0 |
| ex 29.35 Q | Norfloxacin (INN) | 0 |
| ex 29.35 Q | Zotepin (INN) | 4 |

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 29.35 Q | Ofloxacin (INN) | 0 |
| ex 29.35 Q | 3'-Chlor-6'-cyclohexylaminospiro [isobenzofuran-1(3*H*), 9'-xanthen]-3-on | 0 |
| ex 29.35 Q | 6'-(*N*-Äthyl-*p*-toluidin)-2'-(*N*-methylanilin)spiro [isobenzofuran-1(3*H*),9'-xanthen]-3-on | 0 |
| ex 29.44 C | Cefamandol (INN) und seine Salze und Ester | 0 |
| ex 30.02 A | Röteln-Immunplasma | 0 |
| ex 32.07 B | Anorganische Farbmittelzubereitungen im Sinne der Vorschrift 3 zu Kapitel 32 in Hohlkugeln aus Polyurethan mit einem Durchmesser von weniger als 200 Mikrometer | 0 |
| ex 32.09 A II und ex 39.01 C V | Mit einem Gehalt von 48 Gewichtshundertteilen oder mehr in *N*, *N*-Dimethylacetamid gelöstes Polyurethan aus 2,2,'-(*tert*-Butylimino) diäthanol und 4,4'-Methylendicyclohexyldiisocyanat | 0 |
| ex 32.09 A II und ex 39.02 C XIV a) | Mit einem Anteil von 48 Gewichtshundertteilen oder mehr in *N*, *N*-Dimethylacetamid gelöstes Mischpolymerisat aus *p*-Kresol und Divinylbenzol | 0 |
| ex 35.07 | Aspergillus-Alkalin-Proteinase | 0 |
| ex 38.16 | Unsteriles Blutserum, gewonnen aus dem Blut von Rinderföten oder nicht immunisierten neugeborenen Kälbern | 0 |
| ex 38.19 E | Monoalkylbenzol-Gemische aus der Alkylierung von Benzol mit Poly(äthylen) mit einem mittleren Molekulargewicht von nicht weniger als 680 und nicht mehr als 820 | 0 |
| ex 38.19 G | Katalysator in Form von Pulver, aus einer auf einem Träger aus Siliciumdioxid fixierten Mischung von Titan-, Magnesium- und Aluminiumverbindungen mit<br>— nicht weniger als 3 und nicht mehr als 6 Gewichtshundertteilen Titan,<br>— nicht weniger als 2 und nicht mehr als 3 Gewichtshundertteilen Magnesium,<br>— nicht weniger als 0,3 und nicht mehr als 0,5 Gewichtshundertteilen Aluminium,<br>zur Verwendung beim Herstellen von Polyäthylen mit einer Dichte von nicht weniger als 0,935 (a) | 0 |
| ex 38.19 G | Katalysator aus Dialkyldimethylammoniumacetat, Kettenlängen von 16 und 18 Kohlenstoffatomen enthaltend, mit einem Anteil von nicht weniger als 40 Gewichtshuntertteilen in organischen Lösungsmitteln dispergiert | 0 |
| ex 38.19 S | Dotierte Silicium-Scheiben in Czochralski-Technik hergestellt, mit einem Durchmesser von 70 mm oder mehr, nicht poliert, mit einem Anteil an Sauerstoffatomen von $5 \times 10^{17}/cm^3$ oder mehr | 0 |
| ex 38.19 X | 2,3-Bis[2-(perfluoralkyl)äthylthio]butan-1,4-diol | 0 |
| ex 39.01 C II a) | Polykondensationserzeugnis aus Toluol-2- und Toluol-4-sulfonamid mit Formaldehyd | 0 |
| ex 39.01 C III a) | Einseitig metallbedampfte, in der Masse gefärbte Polyesterfolien mit einer Dicke von nicht mehr als 25 Mikrometer | 6 |

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 39.01 C III a) | Polykondensationserzeugnis aus Terephthalsäure mit einer Mischung aus Cyclohex-1,4-ylendimethanol und Aethan-1,2-diol, in Form von Folien | 0 |
| ex 39.01 C III a) | Polyesterfolien mit einer Dicke von nicht mehr als 70 Mikrometer, einseitig beschichtet mit einer Substanz, die sich bei Erhitzung auf nicht mehr als 100 °C unter Einwirkung von Salicylsäure verfärbt | 0 |
| ex 39.01 C III a) | Polyesterfolien mit einer Dicke von nicht mehr als 10 Mikrometer, einseitig beschichtet mit Salicylsäure | 0 |
| ex 39.01 C III b) | Polykondensationserzeugnis aus Terephtalsäure mit einer Mischung aus Cyclohex-1,4-ylendimethanol und Äthan-1,2-diol, in Formen im Sinne der Vorschrift 3 b) zu Kapitel 39 | 0 |
| ex 39.02 C I a) | Polyäthylen in Formen im Sinne der Vorschrift 3 b) zu Kapitel 39, mit einer Dichte von nicht weniger als 0,958 bei 23 °C und einem Gehalt von nicht mehr als<br>— 50 ppm Aluminium,<br>— 2 ppm Calcium,<br>— 2 ppm Chrom,<br>— 2 ppm Eisen,<br>— 2 ppm Nickel,<br>— 2 ppm Titan,<br>— 8 ppm Vanadium,<br>zum Herstellen von chlorsulfoniertem Polyäthylen (a) | 0 |
| ex 39.02 C I a) | Polyäthylen mit einer Dichte von nicht weniger als 0,945 und nicht mehr als 0,985, in Formen im Sinne der Vorschrift 3 b) zu Kapitel 39, zum Herstellen von Farbbändern für Schreibmaschinen und ähnlichen Farbbändern (a) | 0 |
| ex 39.02 C VI a) | A-B-A-Blockmischpolymerisat aus Polystyrol, Äthylen-Butylen-Mischpolymerisat und Polystyrol, mit einem Gehalt an Styrol von nicht mehr als 35 Gewichtshundertteilen, in Formen im Sinne der Vorschrift 3 b) zu Kapitel 39 | 0 |
| ex 39.02 C VI b) | Platten aus einem Mischpolymerisat aus Maleinsäureanhydrid und Styrol, beidseitig versehen mit einer Folie aus dem genannten Mischpolymerisat, modifiziert mit einem Styrol-Butadien-Blockmischpolymerisat, auch pigmentiert | 0 |
| ex 39.02 C XI | Polyvinylalkoholfolien, die sich in Wasser bei einer Temperatur von 20 °C auflösen | 0 |
| ex 39.02 C XI | Polyvinylbutyralfolien mit Farbkeilband | 6 |
| ex 39.02 C XIV a) | Vinylidenchlorid-Acrylnitril-Mischpolymerisat in Form von dehnbaren Kügelchen mit einem Durchmesser von nicht weniger als 4 Mikrometer und nicht mehr als 20 Mikrometer | 0 |
| ex 39.02 C XIC a) | Ionomeres Harz, bestehend aus einem Salz eines Äthylen-Methacrylsäure-Mischpolymerisats | 0 |
| ex 39.02 C XIV a) | Ionomeres Harz, bestehend aus einem Salz eines Äthylen-Isobutylacrylat-Methacrylsäure-Mischpolymerisats | 0 |
| ex 39.02 C XIV a) | Mischpolymerisat aus Acrylsäure und Alkylmethacrylat mit geringen Mengen eines anderen Monomeren, zur Verwendung als Verdickungsmittel beim Herstellen von Druckpasten für den Textildruck (a) | 0 |

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 39.02 C XIV a) | Mischpolymerisat aus Vinylalkohol und Äthylen, in Formen im Sinne der Vorschrift 3 b) zu Kapitel 39 | 6 |
| ex 39.02 C XIV a) | Äthylen-Acrylsäure- oder Äthylen-Methacrylsäure-Mischpolymerisat in Formen im Sinne der Vorschrift 3 b) zu Kapitel 39, mit einem Gehalt an Acrylsäure oder Methacrylsäure von nicht weniger als 16 und nicht mehr als 30 Gewichtshundertteilen | 0 |
| ex 39.02 C XIV b) | Folien aus einer Mischung von Polyvinylidenfluorid und einem Acrylpolymer mit einer Dicke von nicht weniger als 40 und nicht mehr als 60 Mikrometer | 0 |
| ex 39.02 C XIV b) | Platten aus einem Äthylen-Chlortrifluoräthylen-Mischpolymerisat mit einer Dicke von nicht weniger als 1 und nicht mehr als 3 mm, auch auf einer Seite mit einem Glasfasergewebe versehen | 0 |
| ex 39.02 C XIV b) | Folien aus einem Mischpolymerisat aus Äthylen und Chlortrifluoräthylen mit einer Dicke von nicht weniger als 12 und nicht mehr als 400 Mikrometer | 0 |
| ex 39.03 B V a) 2 | Äthylhydroxyäthylzellulose, in Wasser nicht löslich | 4 |
| ex 39.03 B V a) 2 | Hydroxypropylzellulose | 0 |
| ex 40.05 C | Streifen, aus Polybutadien-Acrylnitril (NBR), in der Masse Mikrokügelchen enthaltend, auf der Oberseite mit einer Polyvinylchloridfolie laminiert, die mit Mikrokügelchen versehen ist | 0 |
| ex 48.07 C | Papier aus gebleichtem Halbstoff, entweder mit Acrylharz getränkt und mit Polyvinylidenchlorid überzogen oder mit Acrylharz überzogen, mit einer Dicke von nicht weniger als 170 und nicht mehr als 320 Mikrometer und einem Quadratmetergewicht von nicht weniger als 165 und nicht mehr als 210 g | 0 |
| ex 51.02 A I | Monofile aus Polytetrafluoräthylen | 0 |
| ex 56.01 A | Acetalisierte Mehrkomponenten-Spinnfasern mit Matrixfibrillenstruktur, bestehend aus emulsionspolymerisiertem Polyvinylalkohol und Polyvinylchlorid | 0 |
| ex 59.03 B | Vliesstoffe aus Polyvinylalkohol, mit einer Dicke von nicht weniger als 200 und nicht mehr als 280 Mikrometer und einem Quadratmetergewicht von nicht weniger als 20 und nicht mehr als 50 g, als Meterware oder nur quadratisch oder rechteckig zugeschnitten, auch getränkt oder bestrichen | 0 |
| ex 59.17 A | Nadelfilze aus synthetischen Spinnstoffen mit einem Grundgewebe aus synthetischen Spinnstoffen, auf einer Seite mit einem Polytetrafluoräthylenfilm versehen, zum Herstellen von Filtermaterial (a) | 0 |
| ex 70.07 | Plane, bleihaltige Flachglasscheiben, geschliffen und poliert, mit bearbeiteten Kanten, mit<br>— einer Dicke von nicht weniger als 3,5 und nicht mehr als 5 mm,<br>— einem Durchmesser von nicht weniger als 135 und nicht mehr als 140 mm,<br>— einer Dichte von 2,88 g/cm³ oder mehr und<br>— einer Lichtdurchlässigkeit von 87 % oder mehr bei Wellenlängen von nicht weniger als 450 und nicht mehr als 800 Nanometern, zum Einbau in Videoprojektoren (a) | 0 |

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 70.11 | Bildschirme, ganz aus Glas, mit einer Diagonalen von nicht mehr als 61 cm, mit aufgeworfenem Rand, zum Herstellen von monochromen Kathodenstrahlröhren (a) | 0 |
| ex 70.11 | Konen mit profiliertem Rand und einer Diagonalen von nicht mehr als 61 cm, zum Herstellen von monochromen Kathodenstrahlröhren (a) | 0 |
| ex 81.04 D I b) | Elektrolytisch gewonnenes Chrom, in Form von Kathodenplättchen, Briketts oder Pellets, mit einem Gesamtgehalt an Sauerstoff von nicht mehr als 0,10 Gewichtshundertteilen, einem Gesamtgehalt an Aluminium von nicht mehr als 0,015 Gewichtshundertteilen und einem Gehalt an in siedender 5 n Salzsäure und in siedender, rauchender Perchlorsäure unlöslichen und als Aluminium berechneten Aluminiumverbindungen von nicht mehr als 0,001 Gewichtshundertteilen zur Herstellung von einer Legierung für den Bau von folgenden Teilen von Gasturbinen oder Strahltriebwerken (a):<br>— feststehende oder bewegliche Schaufelräder, einschließlich ihrer Ringe,<br>— Klappen,<br>— Düsen | 0 |
| ex 81.04 F I | Hafnium, roh, mit einem Reinheitsgrad von 95 Gewichtshundertteilen oder mehr und einem Gehalt an Zirkonium von nicht mehr als 4,5 Gewichtshundertteilen | 0 |
| ex 84.17 F II | Tauchrohrbündel, bestehend aus einem System von Kunststoffrohren, die an beiden Enden in eine bienenwabenförmige, von einem Rohrverbindungsstück umschlossene Konstruktion (Abschlußteil) einmünden | 0 |
| ex 84.18 C II b) | Teile von Apparaten zum katalytischen Umwandeln von Stickstoffoxiden in Stickstoff und Wasser, bestehend aus in Wabenstruktur geformten und gebrannten Einheiten aus einer Mischung von Vanadiumoxiden oder Vanadiumsulfaten und Titandioxid oder Bariumsulfat oder von Vanadiumoxid, Titandioxid und Wolframoxid, in einem Rahmengestell aus Metall | 0 |
| ex 84.18 C II b) | Teile von Apparaten zum katalytischen Umwandeln von Stickstoffoxiden in Stickstoff und Wasser, bestehend aus mit einer Mischung von Vanadium-, Titan- und Molybdänoxiden beschichteten perforierten Platten, in einem Rahmengestell aus Metall | 0 |
| ex 84.53 B und ex 84.55 C | Optische Schriftleser zum Abtasten von Punktmatrixzeichen und zum Umwandeln der Leseimpulse in elektrische Signale, bestehend aus einem Lesekopf mit Photosensor, einem Verstärker, einer Linse und zwei Lampen, über zwei Flachkabel verbunden mit einer gedruckten Schaltung mit den Abmessungen von nicht mehr als 200 × 220 mm, die mindestens einen Mikroprozessor, eine Bilderkennungsschaltung und einen Analog-Digital-Wandler enthält. | 1 |
| ex 84.55 C | Magnetköpfe in Winchester- oder Dünnfilmtechnik für periphere Magnetplatten-Speichereinheiten, mit einer Aufzeichnungsdichte von nicht weniger als 10 Spuren je mm, auch auf Trägerarmen | 0 |
| ex 84.55 C | Punktmatrix-Anzeigen mit den Abmessungen von nicht mehr als 15 × 90 × 280 mm — ausgenommen Anschlußstücke und Leitungen —, bestehend aus einer zwischen zwei Glasplatten eingeschlossenen Flüssigkristallschicht mit 30 720 Punkten (angeordnet in 64 Zeilen und 480 Kolonnen), auf einer Leiterplatte mit elektronischen Bauelementen zur Steuerung und Kontrolle, auch mit Leitungen und Anschlußstücken | 0 |
| ex 84.55 C | Punktmatrix-Anzeigen mit den Abmessungen von nicht mehr als 15 × 75 × 186 mm, bestehend aus einer zwischen zwei Glasplatten eingeschlossenen Flüssigkristallschicht mit 15 360 Punkten (angeordnet in 64 Zeilen und 240 Kolonnen), auf einer Leiterplatte mit elektronischen Bauelementen in C-MOS-Technik, und mit nicht mehr als 544 Kontaktflächen | 0 |

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 84.55 C | Magnetische Schreib-Lese-Elemente in Dünnfilmtechnik zum Herstellen von Magnetköpfen für periphere Magnetplatten-Speichereinheiten, mit einer Aufzeichnungsdichte von nicht weniger als 10 Spuren je mm, in Form von Platten mit den Abmessungen von nicht mehr als 48 × 48 mm und mit 200 Elementen oder mehr oder in Form von Streifen mit den Abmessungen von nicht mehr als 4 × 48 mm und mit 10 Elementen oder mehr (a) | 0 |
| ex 84.55 C | Baugruppe für automatische Datenverarbeitungsmaschinen, bestehend aus 2 übereinander angeordneten Substratebenen mit je 2 statischen Schreib-Lesespeichern mit wahlfreiem Zugriff in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt (sogenannte N/H-MOS-RAMs, statisch), in Form von monolithischen integrierten Schaltungen mit einer Speicherkapazität von jeweils 2 Kbit und einer Gesamtspeicherkapazität von insgesamt 8 K × 1 bit oder 4 K × 2 bit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 23 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 13 × 13 mm.<br>Das Gehäuse trägt:<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>4598601<br>5121850<br>5121934<br>5121935<br>5122148<br>5123059<br>5123120<br>5123128<br>5123129<br>5123337<br>5123339<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher-Baugruppen der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 84.55 C | Baugruppe für automatische Datenverarbeitungsmaschinen, die einen programmierbaren UV-löschbaren Lesespeicher (sogenannter EPROM) mit einer Gesamtspeicherkapazität von 256 Kbit bildet und aus einem mehrlagigen Substrat mit den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm besteht, auf dem angebracht sind:<br>— zwei programmierbare UV-löschbare Lesespeicher (sogenannte EPROMs), in Form von monolithischen integrierten Schaltungen, mit einer Speicherkapazität von jeweils 128 Kbit und je einem Quarzfenster auf der Oberseite,<br>— ein Decoder in Form einer monolithischen integrierten Schaltung,<br>— ein Entkopplungskondensator,<br>— zwei Widerstände.<br>Die Baugruppe trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält<br>EDH 7832 MM-30<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher-Baugruppen der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 2 |
| ex 84.55 C | Baugruppe für automatische Datenverarbeitungsmaschinen, die einen programmierbaren UV-löschbaren Lesespeicher (sogenannter EPROM) mit einer Gesamtspeicherkapazität von 256 Kbit bildet und aus einem mehrlagigen Substrat mit den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm besteht, auf dem angebracht sind:<br>— vier programmierbare UV-löschbare Lesespeicher (sogenannte EPROMs), in Form von monolithischen integrierten Schaltungen mit einer Speicherkapazität von jeweils 64 Kbit und je einem Quarzfenster auf der Oberseite,<br>— ein Decoder in Form einer monolithischen integrierten Schaltung,<br>— ein Entkopplungskondensator. | |

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 84.55 C *(Fortsetzung)* | Die Baugruppe trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>EDH 7832 MC-35<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher-Baugruppen der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 2 |
| ex 84.55 C | Baugruppe für automatische Datenverarbeitungsmaschinen, die einen statischen Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in C-MOS-Technik (sogenannter C-MOS-RAM, statisch) mit einer Gesamtspeicherkapazität von 32 Kbit bildet und aus einem mehrlagigen Substrat mit den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm besteht, auf dem angebracht sind:<br>— zwei statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannte C-MOS-RAMs, statisch), in Form von monolithischen integrierten Schaltungen, mit einer Speicherkapazität von jeweils 16 Kbit,<br>— ein Decoder in Form einer monolithischen integrierten Schaltung,<br>— ein Entkoppelungskondensator.<br>Die Baugruppe hat nicht mehr als 28 Anschlußstifte und trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>EDH-8804 C-20<br>EDH 8804 CL-20<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher-Baugruppen der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 2 |
| ex 84.55 C | Baugruppe für automatische Datenverarbeitungsmaschinen, die einen statischen Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in C-MOS-Technik (sogenannter C-MOS-RAM, statisch) mit einer Gesamtspeicherkapazität von 64 Kbit bildet und aus einem mehrlagigen Substrat mit den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm besteht, auf dem angebracht sind:<br>— vier statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannte C-MOS-RAMs, statisch), in Form von monolithischen integrierten Schaltungen mit einer Speicherkapazität von jeweils 16 Kbit,<br>— ein Decoder in Form einer monolithischen integrierten Schaltung,<br>— ein Entkopplungskondensator.<br>Die Baugruppe hat nicht mehr als 28 Anschlußstifte und trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>EDH 8808 B-20<br>EDH 8808 C-10<br>EDH 8808 C-12<br>EDH 8808 C-15<br>EDH 8808 C-20<br>EDH 8808 CL-15<br>EDH 8808 CL-20<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher-Baugruppen der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 2 |
| ex 84.55 C | Baugruppe für automatische Datenverarbeitungsmaschinen, bestehend aus 2 übereinander angeordneten Substratebenen mit je 2 quasistatischen Schreib-Lesespeichern mit wahlfreiem Zugriff in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt (sogenannte N/H-MOS-RAMs, quasistatisch), in Form von monolithischen integrierten Schaltungen mit einer Speicherkapazität von jeweils 4 Kbit und einer Gesamtspeicherkapazität von insgesamt 16 K × 1 bit oder 8 K × 2 bit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 13 × 13 mm. | |

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 84.55 C *(Fortsetzung)* | Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>4599766<br>4599767<br>4599768<br>4599769<br>4599770<br>4599771<br>4599772<br>4599773<br>4599774<br>4599893<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf quasistatische Schreib-Lesespeicher-Baugruppen der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 84.55 C | Baugruppe für automatische Datenverarbeitungsmaschinen, die einen programmierbaren UV-löschbaren Lesespeicher (sogenannter EPROM) mit einer Speicherkapazität von 64 Kbit und einen statischen Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in C-MOS-Technik (sogenannter C-MOS-RAMs, statisch) mit einer Gesamtspeicherkapazität von 32 Kbit bildet und aus einem mehrlagigen Substrat mit den Abmessungen von nicht mehr als 17 x 39 mm besteht, auf dem angebracht sind:<br>— ein programmierbarer UV-löschbarer Lesespeicher (sogenannter EPROM) mit einer Speicherkapazität von 64 Kbit und einem Quarzfenster auf der Oberseite,<br>— zwei statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannte C-MOS-RAMs, statisch), in Form von monolithischen integrierten Schaltungen mit einer Speicherkapazität von jeweils 16 Kbit,<br>— ein Decoder in Form einer monolithischen integrierten Schaltung,<br>— ein Entkopplungskondensator,<br>— zwei Widerstände.<br>Die Baugruppe hat nicht mehr als 28 Anschlußstifte und trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>EDH 90804 BS-25 (15)<br>EDH 90804 BS-30 (20)<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Baugruppen der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 2 |
| ex 84.55 C | Baugruppe für automatische Datenverarbeitungsmaschinen, bestehend aus 2 übereinander angeordneten Substratebenen mit 1 oder 2 statischen Schreib-Lesespeichern mit wahlfreiem Zugriff in bipolarer Technik hergestellt (sogenannte bipolare RAMs, statisch), in Form von monolithischen integrierten Schaltungen, mit einer Speicherkapazität von jeweils 1 Kbit und einer Gesamtspeicherkapazität von nicht mehr als 4 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 23 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 13 x 13 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>770965<br>4599497<br>7379442<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher-Baugruppen der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 84.55 C | Magnetblasenspeicher mit einer Speicherkapazität von nicht mehr als 4 Megabit, in einem Gehäuse von nicht mehr als 42 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 43 x 44 mm. | |

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 84.55 C *(Fortsetzung)* | Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>BDL 0133 MBM 2011 FBM 64 DA<br>BDL 0134 MBM 2256 7110<br>BDN 0151 FBM 54 DB 7114-1<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Magnetblasenspeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 84.55 C | Arithmetisches logisches Element für die Zentraleinheit, bestehend aus nicht mehr als neun gedruckten Schaltungen mit den Abmessungen von nicht mehr als 290 × 310 mm, jeweils bestückt mit nicht mehr als 121 ECL-Gate Arrays oder ECL-Schreib-Lesespeichern mit wahlfreiem Zugriff (sogenannte ECL-RAMs) oder einer Kombination von beiden, die sich in einem Gestell mit den Abmessungen von nicht mehr als 501 × 596 × 611 mm befinden, das als Halterung und Verbindungsleiter für die gedruckten Schaltungen dient.<br>Das Element trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>CO1B 2675 E 500<br>CO1B 2675 H 500<br>CO1B 2675 H 501<br>CO1B 2675 H 502<br>CO1B 2675 H 503<br>CO1B 2675 H 504<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf arithmetische logische Elemente der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 84.55 C | Punktmatrix-Anzeigen mit den Abmessungen von nicht mehr als 15 × 115 × 290 mm – ausgenommen Anschlußstücke und Leitungen – bestehend aus einer zwischen zwei Glasplatten eingeschlossenen Flüssigkristallschicht mit 128 000 Punkten (angeordnet in 200 Zeilen und 640 Kolonnen), auf einer Leiterplatte mit elektronischen Bauelementen zur Steuerung und Kontrolle, auch mit Leitungen und Anschlußstücken | 0 |
| ex 84.59 B | In einem Stück geschmiedete und vorgedrehte Teile von Reaktordruckbehältern mit einem Stückgewicht von jeweils mehr als 150 t | 0 |
| ex 84.61 B | Hydraulisches Fünfstufenventil, bestehend im wesentlichen aus drei Kunststoffteilen und zwei Magnetventilen zur Servosteuerung, zum Einbau in Wasserenthärtungsanlagen mit automatischer Regeneration (Strom und Gegenstsrom) und einer Ionenaustauschkapazität von nicht mehr als 650 l (a) | 0 |
| ex 84.63 B II | In einem Stück geschmiedete und vorgedrehte Generator- und Turbinenwellen mit einem Stückgewicht von jeweils mehr als 215 Tonnen | 0 |
| ex 85.01 B I b) | Bürstenlose Gleichstrommotoren mit einem Drehmoment von nicht mehr als 0,20 Newtonmeter/Nm, eingebauter elektronischer Steuerungsplatte, Außenrotor mit kreisförmigem Querschnitt mit einem Durchmesser von nicht mehr als 95 mm, Aluminium-Präzisionsnabe mit einem Innendurchmesser von 28,6 mm, einer Geschwindigkeit von 300 oder 360 Umdrehungen pro Minute und einer Versorgungsspannung von 12 V ± 10 % | 0 |
| ex 85.01 B I b) | Bürstenlose Gleichstrommotoren mit einem Drehmoment von nicht mehr als 0,20 Newtonmeter/Nm, einem Außenläufer mit einem Durchmesser von nicht mehr als 55 mm, einem Befestigungsflansch von 77 mm und einer Präzisionsspindel mit einem Durchmesser von 44 mm mit 4-Phasen-Wicklung, mit einer Nenndrehzahl von 3 600 Umdrehungen pro Minute und einer Versorgungsspannung von 12 V ± 10 %, mit Drähten und Anschlußstücken | 0 |

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 85.01 B I b) | Bürstenlose Zwei- oder Dreiphasen-Gleichstrommotoren mit einem Drehmoment von nicht mehr als 0,20 Newtonmeter/Nm, elektronischer Steuerungsplatte und den Abmessungen von nicht mehr als 85 × 85 mm und einer Dicke von nicht mehr als 20 mm einschließlich Spindel, Außenrotor mit einem Durchmesser von nicht mehr als 62 mm, einer Geschwindigkeit von 300 Umdrehungen pro Minute und einer Versorgungsspannung von 12 V ± 10 % | 0 |
| ex 85.01 B I b) | Bipolare Schrittmotoren mit einem Schrittwinkel von 1,8 Grad, 200 Schritten pro Umdrehung, 2-Phasen-Drehfolge mit bipolarer Wicklung, mit den Abmessungen von nicht mehr als 20 × 39 × 39 mm oder 25 × 39 × 39 mm, gemessen ohne Welle, Feststellschrauben und Nabe, mit einem Drehmoment von 0,25 Newtonmeter/Nm oder mehr bei Motoren mit einer Höhe von nicht mehr als 20 mm oder von 0,35 Newtonmeter/Nm oder mehr bei Motoren mit einer Höhe von nicht mehr als 25 mm | 0 |
| ex 85.01 B I b) | Hybrid-Schrittmotoren mit einem Schrittwinkel von 0,9 Grad, 400 Schritten pro Umdrehung, 4-Phasen-Drehfolge mit bipolarer Wicklung, bestehend aus einem Rotor und einem Ständerpaket, das zwischen zwei Viereckflanschen mit den Seitenlängen von nicht mehr als 40 mm eingeschlossen ist, mit durchgehender Welle, Drähten und Anschlußstücken | 0 |
| ex 85.01 B I b) | Hybrid-Schrittmotoren mit einem Schrittwinkel von 0,9 Grad, 400 Schritten pro Umdrehung, 2-Phasen-Drehfolge mit bipolarer Wicklung, bestehend aus einem Rotor und einem Ständerpaket, das in einem zylindrischen Behälter mit einem Durchmesser von nicht mehr als 47 mm und einer Dicke von nicht mehr als 14 mm eingeschlossen ist, mit durchgehender Welle, Drähten und Anschlußstücken | 0 |
| ex 85.01 B I b) | Hybrid-Schrittmotoren mit einem Schrittwinkel von 0,9 Grad, 400 Schritten pro Umdrehung, 2-Phasen-Drehfolge mit bipolarer Wicklung, bestehend aus einem Rotor und einem Ständerpaket, das zwischen zwei Viereckflanschen mit den Seitenlängen von nicht mehr als 40 mm eingeschlossen ist, mit eingebautem 2- oder 3-Phasen-Drehzahlmesser in einer Kalotte mit einem Durchmesser von nicht mehr als 35 mm, mit gesonderten Drähten und Anschlußstücken für die Ausgänge des Motors und des Drehzahlmessers, mit den Abmessungen von nicht mehr als 40 × 40 × 62 mm, einschließlich Welle | 0 |
| ex 85.01 B II | Stromrichter, bestehend aus einer Kaskadenschaltung von 7 Dioden, für Ausgangsspannungen von 40 kV oder mehr mit einer Stromstärke von 3 mA oder mehr | 0 |
| ex 85.03 | Kohle-/Zink-Trockenbatterien mit einer Spannung von nicht weniger als 5,5 und nicht mehr als 6,5 Volt und einer Größe von nicht mehr als 5 × 90 × 110 mm, zur Verwendung in Filmkassetten für Sofortbildkameras (a) | 0 |
| ex 85.03 | Lithium-Jod-Batterien mit den Abmessungen von nicht mehr als 9 × 23 × 45 mm und einer Spannung von nicht mehr als 2,8 V | 0 |
| ex 85.13 B und ex 85.21 D II | Optoelektronisches Empfangsmodul (PIN-FET-Empfänger) mit einem Wellenlängenbereich von nicht weniger als 1 300 und nicht mehr als 1 600 Nanometern und einer Geschwindigkeit von 678 Megabits/Sekunde oder mehr, in Form einer integrierten hybriden Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 16 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 13 × 13 × 25 mm und ausgerüstet mit einem Lichtwellenumkehrleiter aus optischen Fasern (Pigtail-Ankopplung).<br>Das Modul trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen-/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>416/7/97013<br>QDFI-XXXX-001<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Empfangsmodule der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 85.18 B | Einstellbare Kondensatoren in runder Form mit einer Dicke von nicht mehr als 3 mm, ausgerüstet mit einer Stellschraube in der Mitte und zwei Anschlüssen, mit einer Kapazität von nicht weniger als 5 und nicht mehr als 30 Picofarad, zum Herstellen von Waren des Kapitels 91 (a) | 0 |
| ex 85.19 A | Thermorelais in hermetisch versiegeltem Glasgehäuse, mit den Längenabmessungen – ohne Drähte – von nicht mehr als 35 mm, mit einer maximalen Undichtigkeit von $10^{-6}$ $cm^3$ Helium/Sekunde bei 1 bar innerhalb des Temperaturbereichs von 0 bis 160 °C, zum Einbau in Kompressoren für Kältemaschinen (a) | 0 |
| ex 85.19 A | Reedschalter in Form eines Glasgehäuses, mit nicht mehr als drei elektrischen Kontakten auf Metallzungen und einer kleinen Menge Quecksilber | 0 |
| ex 85.19 C | Gedruckte Schaltung, einseitig bedruckt, mit den Abmessungen von nicht mehr als 30 × 30 mm, zum Herstellen von Waren des Kapitels 91 (a) | 0 |
| ex 85.21 A V | Lochmasken-Farbkathodenstrahlröhren (Elektronenkanonen in Dreiecksanordnung – sogenannte Delta-Technik –), mit einem Abstand zwischen den Farbpunkten von nicht mehr als 0,31 mm und einer Vorrichtung zur Konvergenzautomatik | 0 |
| ex 85.21 A V | Kathodenstrahlspeicherröhren (sogenannte Direktsicht-Speicherröhren/Direct View Storage Tubes) für die Wiedergabe alphanumerischer und analoger Daten, mit Abtastvorrichtung zum Lesen der gebildeten Zeichen | 0 |
| ex 85.21 A V | Lochmasken-Farbkathodenstrahlröhren (Elektronenkanonen in Reihenanordnung – sogenannte In-Line-Technik –), die auf einem Bildschirm mit einer nutzbaren Fläche von nicht mehr als 165 × 165 mm Daten anzeigen, für elektronische Fluginstrumente und Anzeigegeräte (a) | 0 |
| ex 85.21 A V | Lochmasken-Farbkathodenstrahlröhren (Elektronenkanonen in Reihenanordnung – sogenannte In-Line-Technik –), mit einem Abstand zwischen den Farbpunkten von weniger als 0,4 mm und einem oder mehreren der nachstehenden Beschaffenheitsmerkmale:<br>— einer Diagonalen des Bildschirms von 48 cm oder mehr, einer diagonalen Ablenkung von nicht mehr als 90 ° und Konvergenzfehlern in den Ecken von nicht mehr als 0,8 mm,<br>— einem integrierten Anti-Vibrationssystem (sogenanntes Potting-System),<br>— ohne internen Magnetschirm,<br>— einer Phosphorbeschichtung mit folgenden nominalen Koordinaten der Farbpunkte:<br>*rot* *grün* *blau*<br>X 0,64 0,29 0,15<br>Y 0,33 0,60 0,06<br>oder<br>X 0,64 0,31 0,155<br>Y 0,34 0,595 0,07<br>oder<br>X 0,610 0,307 0,150<br>Y 0,350 0,595 0,065<br>oder<br>X 0,61 0,205 0,15<br>Y 0,35 0,680 0,065<br>oder<br>X 0,62 0,29 0,15<br>Y 0,35 0,60 0,065 | 0 |

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 85.21 A V | Lochmasken-Farbkathodenstrahlröhren (Elektronenkanonen in Dreiecksanordnung – sogenannte Deltatechnik –), mit einem Abstand zwischen den Farbpunkten von weniger als 0,4 mm und einem der nachstehenden Beschaffenheitsmerkmale:<br>— einer Diagonalen des Bildschirms von 66 cm oder mehr<br>oder<br>— einer Phosphorbeschichtung mit folgenden nominalen Koordinaten der Farbpunkte:<br>*rot* *grün* *blau*<br>X 0,64 0,29 0,15<br>Y 0,33 0,60 0,06<br>oder<br>X 0,64 0,31 0,155<br>Y 0,34 0,595 0,07<br>oder<br>X 0,610 0,307 0,150<br>Y 0,350 0,595 0,065<br>oder<br>X 0,61 0,205 0,15<br>Y 0,35 0,680 0,065<br>oder<br>X 0,62 0,29 0,15<br>Y 0,35 0,60 0,065 | 0 |
| ex 85.21 A V | Anzeigen in Form einer Röhre, bestehend aus einem Glasgehäuse, aufgebracht auf einer Platte mit einer Größe – ohne Berücksichtigung der Leitungen – von nicht mehr als 300 × 350 mm. Die Röhre enthält eine oder mehrere Reihen von Zeichen oder Strichen. Jedes Zeichen oder jeder Strich enthält fluoreszierende oder phosphoreszierende Elemente, die auf einer von fluoreszierenden Substanzen oder von Phosphorsalzen überzogenen metallisierten Unterlage aufgebracht sind und leuchten, wenn sie von Elektronen getroffen werden | 0 |
| ex 85.21 A V | Monochrome Kathodenstrahlröhren mit flachem Bildschirm, mit einer Diagonalen von nicht weniger als 142 und nicht mehr als 145 mm, einer Leuchtkraft zwischen 300 und 400 Lumen, einem Auflösungsvermögen von nicht weniger als 0,06 und nicht mehr als 0,1 mm, einer Phosphorbeschichtung des Typs P1 oder P55 oder P56, einer Anodenspannung von 34 kV oder mehr, einer Fokussierspannung von 7 kV oder mehr und einem Kathodenstrom von 3 mA oder mehr | 0 |
| ex 85.21 C | Piezoelektrische Quarzkristalle mit einer Frequenz von 32 768 Hz, in einem zylindrischen Gehäuse mit einer Länge von nicht mehr als 8,2 mm und einem Durchmesser von nicht mehr als 3,2 mm, zum Herstellen von Waren des Kapitels 91 (a) | 0 |
| ex 85.21 D II | Digitalanzeigen, in einem Kunststoffgehäuse mit einer Größe von nicht mehr als 25 × 35 mm, bestehend aus einer Leiterplatte, die nicht mehr als 22 Leuchtdioden enthält, die von Halbleiterteilen aus im wesentlichen Gallium hergestellt sind. Jede Anzeige besteht aus einer einzigen Stelle, auch mit Plus- oder Minuszeichen und/oder mit nicht mehr als 2 Dezimalpunkten | 0 |
| ex 85.21 D II | Digitalanzeigen, bestehend aus einer Leiterplatte mit einer Größe von nicht mehr als 35 × 90 mm und einer Reihe von nicht weniger als 2 Anzeigestellen, die Leuchtdioden enthalten, die von Halbleiterteilen aus im wesentlichen Gallium hergestellt sind; letztere sind in die Leiterplatte eingebaut. Jede Anzeigestelle besteht aus nicht mehr als acht Segmenten, auch mit einem Dezimalpunkt. Die Digitalreihe hat einen Schutzbelag aus Kunststoff | 0 |

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II | Monolithische integrierte Schaltung, bestehend aus 8 unabhängigen Elementen für die Steuerung der 8 Segmente und/oder Zeichen von Fluoreszenz- oder Gasentladungsanzeigen, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 18 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 7 × 23 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>513<br>514<br>534<br>594<br>6118<br>6128<br>6138<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf integrierte Schaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Lesespeicher (sogenannter ROM), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 16 K × 8 bit, mit Leseregister und Kontrolle für seriellen Output in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 50 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>62000 bis 62999<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Lesespeicher in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannter C-MOS-ROM), mit einem Versorgungsstrom im Bereitschaftszustand von nicht mehr als 0,03 mA, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 256 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 54 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 50 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>HN 61256<br>HN 613256<br>MB 83256<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 7 |
| ex 85.21 D II | Lesespeicher in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannter C-MOS-ROM), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 1 Megabit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>HN 62301 P,<br>MB 831124,<br>TC 53 1000 P<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 7 |

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II | Programmierbare Lesespeicher, nicht löschbar (sogenannte PROMs), in TTL-Schottky-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 2 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm.<br><br>Das Gehäuse trägt<br><br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br><br>27 S 12 — 5305 — 6305 — 76 LS 03<br>27 S 13 — 5306 — 6306 — 7620<br>5308 — 6308 — 7621<br>28 L 22 — 5309 — 6309<br>28 LA 22 — 53 S 240 — 63 S 240 — 82 S 114<br>28 L 2 XMFC — 53 S 241 — 63 S 241 — 82 S 130<br>6335 — 82 S 131<br>29613 — 54 S 570 — 6336<br>29770 — 54 S 571 — 93436<br>29771 — 7053 — 93446<br>5604 — 7058<br>38510 — 5624 — MB 7115<br>74 S 570 — MB 7116<br>74 S 571 — MB 7117<br>MB 7118<br><br>oder<br><br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Programmierbare Lesespeicher, nicht löschbar (sogenannte PROMs), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 4 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften oder nicht mehr als 28 Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm.<br><br>Das Gehäuse trägt<br><br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br><br>18 S 42 — 29620 — 54 S 472 — 74 S 472<br>18 S 46 — 29621 — 54 S 473 — 74 S 473<br>18 SA 42 — 29622 — 54 S 474 — 74 S 474<br>18 SA 46 — 29623 — 54 S 475 — 74 S 475<br>29624 — 54 S 476 — 74 S 476<br>24 S 41 — 29625 — 54 S 477 — 74 S 477<br>24 SA 41 — 29626 — 54 S 572 — 74 S 572<br>29627 — 54 S 573 — 74 S 573<br>27 S 15 — 54740<br>27 S 25 — 3604 — 54741 — 7640<br>27 S 26 — 3624 — 7641<br>27 S 27 — 3625 — 5605 — 7642<br>27 S 28 — 5625 — 7643<br>27 S 29 — 38510 — 7644<br>27 S 30 — 6340 — 7645<br>27 S 31 — 5340 — 6341 — 7646<br>27 S 32 — 5341 — 63 S 440 — 7647<br>27 S 33 — 53 S 440 — 63 RA 441 — 7648<br>53 RA 441 — 63 RS 441 — 7649<br><br>28 L 42 — 53 RS 441 — 63 S 441<br>28 L 45 — 53 S 441 — 6348 — 82 HS 137<br>28 L 46 — 5348 — 6349 — 82 HS 147<br>28 P 42 — 5349 — 6350 — 82 S 115<br>28 P 45 — 5350 — 6351 — 82 S 136<br>28 R 45 — 5351 — 6352 — 82 S 137<br>28 S 4 XPD — 5352 — 6353 — 82 S 140<br>28 SA 41 — 5353 — 82 S 141 | |

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II<br>*(Fortsetzung)* | 28 S 42<br>28 SA 42<br>28 S 45<br>28 S 46<br>28 SA 46<br><br><br><br><br><br><br>HM 6641<br><br>7054<br>7059<br><br>7121<br>7122<br>7123<br>7124<br>7125<br>7126<br>7226<br><br>82 S 142<br>82 S 146<br>82 S 147<br><br>93438<br>93448<br>93452<br>93453<br><br><br><br><br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Programmierbare Lesespeicher, nicht löschbar (sogenannte PROMs), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 8 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften oder nicht mehr als 28 Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm.<br><br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>24 S 81<br>24 SA 81<br>24 S 86<br><br>27 S 180<br>27 S 181<br>27 S 185<br>27 S 35<br><br>28 L 85<br>28 L 86<br>28 P 85<br>28 R 35<br>28 R 85<br>28 S 2708<br>28 S 85<br>28 S 86<br>28 SA 86<br>28 S 8 XMFE<br><br>29623<br>29630<br>29631<br>29632<br>29633<br>29634<br>29635<br>29636<br>29637<br>29650<br>29651<br>29652<br>29653<br><br>3628<br><br>5380<br>5381<br>5388<br>5389<br>53 S 840<br>53 S 841<br><br>54 LS 478<br>54 S 2708<br>54 S 454<br>54 S 455<br>54 S 478<br>54 S 479<br><br>6380<br>6381<br>6388<br>6389<br>63 S 840<br>63 S 841<br><br>7050<br>7055<br>7060<br><br>7127<br>7128<br>7129<br>7130<br>7131<br>7132<br>7232<br><br>74 LS 478<br>74 S 2708<br>74 S 454<br>74 S 455<br>74 S 478<br>74 S 479<br><br>7608<br>7680<br>7681<br>7684<br>7685<br>7686<br>7687<br>7688<br>7689<br><br>77 S 180<br>77 S 181<br>77 S 184<br>77 S 185<br>77 S 186<br>77 S 187<br><br>TBPS 81 M<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>82707<br>82708<br>82 HS 185<br>82 LS 180<br>82 LS 181<br>82 S 180<br>82 S 181<br>82 S 182<br>82 S 183<br>82 S 184<br>82 S 185<br>82 S 2708<br><br>87 S 180<br>87 S 181<br>87 S 184<br>87 S 185<br>87 S 186<br>87 S 187<br><br>93450<br>93451<br>93460<br>93461<br>93465<br>93466<br>93 L 450<br>93 L 451<br><br>9460<br><br><br><br><br><br><br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II | Programmierbare UV-löschbare Lesespeicher (sogenannte EPROMs), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 2 Kbit, in einem Gehäuse mit den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm und einem Quarzfenster auf der Oberseite.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>AMI 702 ADC<br>82140 PP<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 4 |
| ex 85.21 D II | Programmierbare UV-löschbare Lesespeicher (sogenannte EPROMs) mit programmierbaren Ein- und Ausgangsstellen, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 2 K × 8 bit, in einem Gehäuse mit den Abmessungen von nicht mehr als 15 × 52 mm und einem Quarzfenster auf der Oberseite.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>D 8755 A, TMP 8755 AC<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Elektrisch löschbare, programmierbare Lesespeicher (sogenannte E²PROMs), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung mit einer Speicherkapazität von 256 bit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 8 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 10 × 12 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>NMC 9306<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Elektrisch löschbare, programmierbare Lesespeicher (sogenannte E²PROMs), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung mit einer Speicherkapazität von 4 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 33 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>X 2804 A, X 2404, X 24 C 04<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Elektrisch löschbare, programmierbare Lesespeicher (sogenannte E²PROMs), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 16 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 32 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. | |

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(Fortsetzung)* | Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>X 24 C 16<br>X 2816 A<br>52 B 13<br>52 B 13 H<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Elektrisch löschbare, programmierbare Lesespeicher (sogenannte $E^2$PROMs), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung mit einer Speicherkapazität von 64 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 32 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>X 2864 A<br>MCM 2864<br>52 B 33<br>52 B 33 H<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Elektrisch löschbare, programmierbare Lesespeicher (sogenannte $E^2$PROMs), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 128 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 32 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>X 28128 A<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Elektrisch löschbare, programmierbare Lesespeicher (sogenannte $E^2$PROMs), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 256 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 32 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder diese Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>28256<br>28 C 256<br>48 C 256<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in TTL-Technik hergestellt (sogenannte TTL-RAMs, statisch), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 1 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 22 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 30 mm. | |

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(Fortsetzung)* | Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>2205 74 LS 214 93412<br>74 LS 215 93 L 412<br>2510 74 LS 314 93415<br>2511 74 LS 315 93 L 415<br>74 S 207 93422<br>74 S 208 93 L 422<br>74 S 214 93425<br>74 S 314 93 F 425<br>93 L 425<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt (sogenannte N/H-MOS-RAMs, statisch), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 1 K × 4 bit und einer Zugriffszeit von nicht mehr als 70 Nanosekunden, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 18 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 8 × 23 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>AM 2149<br>PD 2149<br>SY 2149 H<br>TMS 2149<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 7 |
| ex 85.21 D II | Statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannte C-MOS-RAMs, statisch), mit einer Speicherkapazität von 4 K × 1 bit, einer Zugriffszeit von nicht mehr als 70 Nanosekunden und einem Versorgungsstrom im Bereitschaftszustand von weniger als 1 mA, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 18 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 9 × 26 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>6147<br>MCM 61 L 47<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannte C-MOS-RAMs, statisch), mit einer Speicherkapazität von 2 K × 8 bit und einer Leistung im Bereitschaftszustand von nicht mehr als 0,005 Milliwatt bei 25 °C, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 33 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>TC 5516 A<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 7 |

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II | Statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt (sogenannte N/H-MOS-RAMs, statisch), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 8 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen-Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>4008 8104<br>8108<br>4118 8112<br>PD 421 8114<br>8185<br>4801<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt (sogenannte N/H-MOS-RAMs, statisch), in Form von monolithischen integrierten Schaltungen, bestehend aus 2 übereinander angeordneten Substratebenen mit jeweils 2 Chips mit einer Speicherkapazität von je 2 Kbit und einer Gesamtspeicherkapazität von 8 K × 1 bit oder 4 K × 2 bit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 23 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 13 × 13 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>4598601<br>5121850<br>5121934<br>5121935<br>5122148<br>5123059<br>5123120<br>5123128<br>5123129<br>5123337<br>5123339<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff, in N-MOS (einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt (sogenannte N/H-MOS-RAMs, statisch), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 256 × 4 bit und einer Zugriffszeit von nicht mehr als 25 Nanosekunden, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>9122 – 25<br>91 L 22 – 25<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II | Statische Schreib-Lesespeicher, mit wahlfreiem Zugriff in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannte C-MOS-RAMs, statisch), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 64 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 32 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 18 × 39 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>TC 5564 MB 8464<br>TC 5565 C MB 81C71<br>MCM 6164<br>HM 6264 P<br>HM 6264 LFP<br>HM 6264 LP<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Monolithische integrierte Schaltung, bestehend aus einem statischen Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM, statisch), mit einer Speicherkapazität von 256 bit, bitweise gekoppelt mit einem elektrisch löschbaren Lesespeicher (sogenannter E²PROM), in einem Gehäuse mit nicht mehr als 18 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 8 × 24 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält<br>X 2210<br>X 2443<br>X 2444<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf monolithische integrierte Schaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Monolithische integrierte Schaltung, bestehend aus einem statischen Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM, statisch), mit einer Speicherkapazität von 2 Kbit, bitweise gekoppelt mit einem elektrisch löschbaren Lesespeicher (sogenannter E²PROM), in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>X 2002<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf monolithische integrierte Schaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Monolithische integrierte Schaltung, bestehend aus einem statischen Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM, statisch), mit einer Speicherkapazität von 4 Kbit, bitweise gekoppelt mit einem elektrisch löschbaren Lesespeicher (sogenannter E²PROM), in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>X 2004<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf monolithische integrierte Schaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II | Quasistatische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in N-MOS (einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt (sogenannte N/H-MOS-RAMs, quasistatisch), in Form von monolithischen integrierten Schaltungen, bestehend aus 2 übereinander angeordneten Substratebenen mit jeweils 2 Chips mit einer Speicherkapazität von je 4 Kbit und einer Gesamtspeicherkapazität von insgesamt 16 K × 1 bit oder 8 K × 2 bit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 13 × 13 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>4599766 4599769 4599772 4599893<br>4599767 4599770 4599773<br>4599768 4599771 4599774<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf quasistatische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in ECL-Technik hergestellt (sogenannte ECL-RAMs), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 4 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 11 × 32 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>PB 10474 10470<br>100474 10474<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Vom Anwender teilweise programmierbare Schaltmatrix (sogenannter Programmable Logic Array/PLA), in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit schmelzbaren Verbindungsstücken, einer programmierbaren UND-Anordnung, einer festen ODER-Anordnung, mit nicht mehr als 20 Eingangsstellen und nicht mehr als 10 Ausgangsstellen, auch mit Registern in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 19 × 39 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine der Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>10 H 8 16 A 4 18 L 4<br>10 L 8 16 C 1<br>16 H 2 20 C 1<br>12 H 6 16 L 2 20 L 2<br>12 L 6 16 L 6 20 L 10<br>12 L 10 16 L 8 20 R 4<br>16 R 4 20 X 4<br>14 H 4 16 R 6 20 X ·<br>14 L 4 16 R 8 20 X 10<br>14 L 8 16 X 4<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf eine Schaltmatrix der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 5 |
| ex 85.21 D II | Vom Anwender programmierbare, nicht löschbare Schaltmatrix (sogenannter Field Programmable Logic-Array/FPLA), in TTL-Schottky-Technik hergestellt, mit nicht mehr als 48 UND-Funktionen und nicht mehr als 8 ODER-Funktionen sowie nicht mehr als 16 Eingangsstellen, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: | |

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(Fortsetzung)* | FP 54 AS 839 FP 74 AS 839 82 S 100<br>FP 54 AS 840 FP 74 AS 840 82 S 101<br>SN 54 LS 333 SN 74 LS 333<br>SN 54 LS 334 SN 74 LS 334 93458<br>SN 54 LS 335 SN 74 LS 335 93459<br>SN 54 LS 336 SN 74 LS 336<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf eine Schaltmatrix der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 5 |
| ex 85.21 D II | Programmierte Schaltmatrix (Gate Array) in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung mit nicht weniger als 8 000 Zwei-Eingangs-NAND-Funktionen, in einem Gehäuse mit 179 oder mehr Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 39 × 39 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>MB 66000 VH<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf eine Schaltmatrix der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Video-Schaltmatrix (sogenannter Video Gate Array) zur Kontrolle von Graphik und Speicher, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und Abmessungen von nicht mehr als 15 × 52 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>PGVA<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf eine Video-Schaltmatrix der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Ein-Chip-Mikrocomputer in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, besteht aus einer arithmetischen, logischen Einheit (Rechenwerk) mit einer Kapazität von 4 bit, einem Lesespeicher (sogenannter ROM) mit einer Speicherkapazität von 18 Kbit bis 65 Kbit, einem Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Speicherkapazität von 512 bit bis 4 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 80 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 58 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>CD 3200 bis 3299 TP 0310 bis 03299 HD 38800<br>TP 0450 bis 04599 HD 38820<br>TMC 0270 bis 0279 TP 0480 bis 04899 HD 44796<br>TMC 0500 bis 0599 TP 0500 bis 05999 HD 44800<br>TMC 0980 bis 0989 HD 44801<br>TMC 1500 bis 1599 HD 44820<br>TMC 1980 bis 1999 HD 44840<br>HD 44860<br>HD 614042<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Ein-Chip-Mikrocomputer der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Zentraleinheiten (sogenannte Central Processing Units/CPU), in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, bestehend aus einem 16 × 16 bit-Dienstspeicher, einem 16 × 20 bit-Dienstspeicher, einem 32 × 32 | |

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(Fortsetzung)* | bit-Dienstspeicher, einem 8 × 8 bit-Dienstspeicher, einem 16-bit-Register, zwei 20-bit-Registern, einem 8-bit-Register, einem 12-bit-Register, einem 5-bit-Zähler und einem Zeitgeber, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 25 × 25 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil hat<br>LSI-604041855<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Zentraleinheiten der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Kontrollbaustein zum Steuern der Zugangsfolge (sogenannter Local Area Network Controller/LAN-Controller), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 48 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 63 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>MCM 68590<br>AM 7990<br>8001<br>8003<br>82586<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Kontrollbaustein zur Steuerung von Magnetplattenspeichern mit festen Platten (Hard Disc Controller/HDC), in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 15 × 53 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>WD 1010 WD 2010<br>PD 7261<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Arithmetische, logische Einheit (Rechenwerk) in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, bestehend aus einem 32-bit-Register, einem 24-bit-Register, einem 4-bit-Register, zwölf 1-bit-Registern, zwei 16 × 24 bit-Dienstspeichern, einem logischen Element zum Durchführen arithmetischer und logischer Operationen, einer Decodierlogik, einem logischen Element zur Fehlersuche und -beseitigung, einem 8-bit-Zähler und einem Zeitgeber, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 64 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 23 × 82 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>ALU 0486<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Rechenwerke der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Logischer Kontrollbaustein, in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, bestehend aus einem 7-bit-Register, drei Zeitzählern (Timer), einem Wähler (Multiplexer), Elementen zur Folgekontrolle, einer Decodierlogik, | |

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(Fortsetzung)* | einem logischen Element zur Fehlersuche und -beseitigung und einem Zeitgeber, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 64 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 23 × 82 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>MIC 0482<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Taktgeber in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, für Zentraleinheit (sogenannte Central Processing Unit/CPU), Hauptspeicher und Ein- und Ausgangsschnittstellen, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 25 × 25 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>H 108982 (MCC)<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Taktgeber der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Baustein zur Folgekontrolle, in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, bestehend aus einem 32-bit-Register, drei 16-bit-Registern, einem 16 × 16 bit-Dienstspeicher, einem 7 × 17 bit-Kellerspeicher (Last in first out/Lifo), einem Addierwerk, einer Decodierlogik, einer Prioritätslogik, einem logischen Element zur Fehlersuche und -beseitigung, einem 16-bit-Wähler (Mulitplexer), einem 8-bit-Zähler und einem Zeitgeber, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 64 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 23 × 82 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>CSS 0484<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Kontrollbaustein zur Fehlersuche und -beseitigung (sogenannter Error Detection and Correction Circuit), in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit nicht mehr als 48 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 62 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>2960<br>74 F 630<br>74 F 631<br>DP 8400<br>74 LS 630<br>74 LS 631<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II | Kontrollbaustein zur Fehlersuche und -beseitigung von einzelnen Bit-Fehlern und zur Fehlersuche von doppelten Bit-Fehlern (sogenannter Error Detection and Correction Circuit), in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 25 × 25 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>8206<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Kontrollbaustein zur Fehlersuche und -beseitigung von Mehrfachfehlern im Magnetplattensystem (sogenannter Burst Error Processor/BEP) in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 54 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>Z 8065<br>AM 9520<br>AM 9521<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Kontrollbaustein in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, zur Steuerung dynamischer Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM, dynamisch), mit Adressen-Multiplexer und Zeitgeber, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 48 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 62 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>DP 8408<br>DP 8409<br>MB 1422<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Programmierbarer Schnittstellenbaustein (sogenannter Programmable Communication Interface/PCI), in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält<br>8251 A<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 7 |
| ex 85.21 D II | Programmierbarer Schnittstellenbaustein für die Datenübertragung (sogenannte Enhanced Programmable Communication Interface/EPCI), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 38 mm. | |

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(Fortsetzung)* | Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>2661<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Serienschnittstellenbaustein zur Datenstromcodierung oder -decodierung und damit zusammenhängenden Kontrollfunktionen für einen Steuerbaustein zum Steuern der Zugangsfolge (sogenannter Local Area Network), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 33 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>AM 7991<br>8002<br>8023<br>82501<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Schnittstellenbaustein für die parallel-serielle oder seriell-parallele Umsetzung digitaler Signale in Fernsprechapparaten (sogenannter Station Interface Digital/STID), in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>WCC 295 G<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Programmierbarer Intervall-Zeitgeber (sogenannter Programmable Interval Timer/PIT), in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>8253, 8254<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Intervall-Zeitgeber der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 6 |
| ex 85.21 D II | Baustein zur Frequenzdecodierung (sogenannter Demodulator/Tone Decoder) in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 14 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 10 × 21 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>XR 2211<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II | C-MOS-Uhrenschaltungen, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit mehr als 16 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 54 mm, zum Herstellen von Schaltzeituhren oder Armaturbrettuhren und dergleichen für Kraftfahrzeuge oder Krafträder (a).<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>HI 2060<br>HI 2065<br>MSM 5537<br>T 3605<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Uhrenschaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | C-MOS-Uhrenschaltungen, die von einer einzigen 1,5-Volt-Versorgungseinheit gespeist werden, mit LCD-Treiber, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 56 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 15 × 21 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>TC 8219 AF<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Uhrenschaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Verstärker in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 10 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 2 × 4 × 4 mm, zum Herstellen von Waren der Tarifstelle 90.19 B I (a).<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>V 35<br>C 05<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Verstärker der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Vierkanal-Bus-Sendeempfangsbaustein (sogenannter Quad Bus Transceiver) in advanced low power Schottky-Technik hergestellt, mit D-Typ-Registern auf dem Chip und internen 4 bit-Generator/Prüfer auf ungerade Parität, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 20 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 9 × 28 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>AM 2907<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Vierkanal-Bus-Sendeempfangsbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Treiberbaustein (sogenannter Four-Line-Driver) in advanced low power Schottky-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 16 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 7 × 20 mm. | |

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(Fortsetzung)* | Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>AM 26 LS 29<br>AM 26 LS 31<br>SN 75172<br>SN 75174<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Treiberbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Sendeempfangbaustein zur synchronen/asynchronen Datenübertragung (sogenannter Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter/USART) in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 32 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>MSM 82 C 51<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Sendeempfangsbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 7 |
| ex 85.21 D II | 8-bit-Mikroprozessor mit interner Architektur von 16 bit in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, bestehend aus einer Zentraleinheit (sogenannte Central Processing Unit/CPU), einem Zeitgenerator, zwei unabhängigen Kanälen zum Direktzugriffspeicher, einem programmierbaren Unterbrecher (sogenannter Interrupt Controller), drei programmierbaren 16-bit-Taktgebern, einem programmierbaren Speicher und äußerer Chipauswahllogik, einem programmierbaren Bereitschaftszustandsgenerator mit Bus-Kontrolleinheit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 30 × 30 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>80188<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Mikroprozessoren der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 7 |
| ex 85.21 D II | 16-bit-Mikroprozessor in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 25 × 82 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>AM 29116 SBP 9989<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Mikroprozessoren der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | 16-bit-Mikroprozessor in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, bestehend aus einer Zentraleinheit [sogenannte Central Processing Unit (CPU)], einem Zeitgenerator, zwei unabhängigen Kanälen zum Direktzugriffspeicher, einem programmierbaren Unterbrecher (sogenannter Interrupt Controller), drei programmierbaren 16-bit-Taktgebern, einem programmierbaren Speicher und äußerer Chipauswahllogik, einem programmierbaren Bereit- | |

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(Fortsetzung)* | schaftszustandsgenerator mit Bus-Kontrolleinheit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 30 × 30 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>80186<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Mikroprozessoren der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Numerischer Prozessor (sogenannter Numeric Processor Extension/NPX) in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, mit nicht mehr als 14 Registern, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 15 × 52 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>8087-2 TX 32081 W<br>8087-3<br>80287<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf numerische Prozessoren der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Datentrennbaustein für flexible Magnetplatten (sogenannter Floppy Disc Data Separator/FDDS), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 20 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 8 × 27 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>FDC 9216<br>FDC 9216-B<br>WD 9216-00<br>WD 9216-01<br>FDC 9229 T<br>FDC 9229 BT<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf eine Datentrennschaltung der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Phonem-Sprachsynthetisator in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannter C-MOS-Phoneme Speech Synthesizer), mit einem Versorgungsstrom von weniger als 10 mA, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>CM 54104 CM 54166 N2L CD 54123 N2L<br>CM 54145 N2L CD 54121 N2L CD 54147 N2L<br>CM 54146 N2L CD 54122 N2L SC 01 SS1263<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Phonem-Sprachsynthetisatoren der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Dreifacher Video-Digital-Analog-Umsetzer (sogenannter Video Digital-Analog-Converter/VDAC) mit einer Kapazität je Kanal von nicht mehr als 8 bit, mit einer Signalumsetzungszeit von nicht mehr als 25 Nanosekunden, in Form einer monolithischen oder hybriden integrierten | |

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(Fortsetzung)* | Schaltung, auch mit drei Schreib-Lesespeichern mit wahlfreiem Zugriff (sogenannte RAMs) mit einer Speicherkapazität von jeweils nicht mehr als 2 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 61 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 54 × 62 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>VDAC 444 TD TDC 1334<br>RGB DAC 4 T HDAC 34010<br>RGB DAC 8 E HDAC 34020<br>RGB DAC 8 T<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Video-Digital-Analog-Umsetzer der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Differentialverstärker, steuerbar für Signale von 0 bis 400 MHz oder mehr, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 16 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 11 × 11 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>0078-10<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Differentialverstärker der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in bipolarer Technik hergestellt (sogenannte bipolare RAMs, statisch), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung mit einer Speicherkapazität von 64 × 9 bit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 40 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>82 S 09 MBM 93419<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Treiberbaustein für dynamische 8-bit-Speicher (sogenannter Octal Dynamic Memory Driver) in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 20 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 33 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>AM 2965<br>AM 2966<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Treiberbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Bus-Schnittstellenbaustein in bipolarer Technik hergestellt, mit 9-bit- oder 10-bit-Registern, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 9 × 34 mm. | |

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(Fortsetzung)* | Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>AM 29821 AM 29843<br>AM 29823 AM 29844<br>AM 29824<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Mehrbus-Puffer-Schnittstellenbaustein (sogenannter Multiple Bus Puffer) in low power Schottky-Technik hergestellt, für die Fehlersuch- und Beseitigungseinheit, das Datenbus-System und den dynamischen Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM, dynamisch), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 8 × 33 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>AM 2961<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Zustands- und Schiebekontrollbaustein (sogenannte Status and Shift Control Unit) in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 42 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 57 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>AM 2904<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf bipolare Zustands- und Schiebekontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Verstärker, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung, mit den Abmessungen von nicht mehr als 3 × 3 mm, zum Herstellen von Waren der Tarifstelle 90.19 B I (a) | 0 |
| ex 85.21 D II | Text-Coprozessor in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 25 × 25 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>C 82 730<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Text-Coprozessoren der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Ein-Chip-Mikrocomputer in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, bestehend aus einer arithmetischen, logischen Einheit (Rechenwerk) mit einer Kapazität von 8 bit, einem programmierbaren UV-löschbaren Lesespeicher (sogenannter EPROM) mit einer Speicherkapazität von 32 Kbit, einem Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Speicherkapazität von 1 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 15 × 50 mm sowie einem Quarzfenster. | |

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(Fortsetzung)* | Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlenkombination besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>8751 7742<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Ein-Chip-Mikrocomputer der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Ein-Chip-Mikrocomputer in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, bestehend aus einer arithmetischen, logischen Einheit (Rechenwerk) mit einer Kapazität von 32 bit, einem Lesespeicher (sogenannter ROM) mit einer Speicherkapazität von 24 Kbit, einem Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Speicherkapazität von 2 Kbit in einem Gehäuse mit nicht weniger als 84 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht weniger als 30 × 30 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>MB 8764<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Ein-Chip-Mikrocomputer der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Teilnehmerleitung-Sprach-Signal-Baustein (sogenannter Subscriber Line Audio Processing Circuit/SLAC) mit 2 Digitalsignalprozessoren, einem Analog-Digital- und einem Digital-Analog-Umsetzer, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>AM 7901<br>AM 7905<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Warenbeschreibung bezieht. | 7 |
| ex 85.21 D II | Monolithische integrierte Schaltung zur Pulscode-Modulation (sogenannte Pulse Code Modulation/PCM), in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, mit Codier-, Decodier- und Filterfunktionen, mit einer maximalen Datentaktfrequenz von mehr als 3,5 MHz, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 20 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 8 × 26 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>2913<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf integrierte Schaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 7 |
| ex 85.21 D II | Nicht flüchtiger Speicher, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, bestehend aus einem statischen Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannter C-MOS-RAM, statisch) mit einer Speicherkapazität von 16 Kbit und interner Energiequelle, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 33 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>MK 48 Z 02 (B)<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf nicht flüchtige Speicher der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 7 |

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II | Teilnehmerleitung-Schnittstellenbaustein (sogenannter Subscriber Line Interface Circuit/SLIC) mit direkter interner Relais-Ansteuerung, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 18 × 39 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>5502<br>ICME 00155/RIFA (PBL) 3735<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Kontrollbaustein für die Datenein- und -ausgabe und Zeitfolge, in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, mit einem statistischen Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Speicherkapazität von 128 × 8 bit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 54 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>6532<br>CO 10750<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Vierkanal-Steuerbaustein für Schrittmotoren, in bipolarer Technik hergestellt, mit Dioden, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 16 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 6 × 20 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>HA 13007<br>75437 A<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Steuerbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Analog-Digitaler-Steuerbaustein für bürstenlose Motoren, zur Erhaltung einer konstanten Geschwindigkeit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 18 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 6 × 25 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>MGA 3015 A<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Steuerbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Analog-Digitaler-Schnittstellenbaustein in bipolarer Technik hergestellt, für den peripheren Festmagnetplattenspeicher und der Zentraleinheit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 15 × 50 mm. | |

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(Fortsetzung)* | Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>AD 581 C<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Spannungsverstärker für Schrittmotoren, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 20 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 6 × 24 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>P 20 A 579<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Spannungsverstärker der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Baustein für die Organisation des Speichers (sogenannte Memory Management Unit/MMU), in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, mit einer Speicheradressierbarkeit bis zu 16 Megabyte, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 64 Anschlußstiften oder 68 Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 25 × 82 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>68451 L 6 TX 32082 W<br>68451 L 8<br>68451 L 10<br>68451 ZBL 6<br>68451 ZBL 8<br>68451 ZBL 10<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Baustein zur asynchronen Bus-Kontrolle und zur Umwandlung der lokalen Bus-Leitungen in Multiplex-Leitungen in advanced low power Schottky-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 13 × 37 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>68452<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Baustein zur Anzeigenkontrolle und zur Erzeugung von Zeichen (sogenannter Display Controller und Character Generator/DCCG) in C-MOS-Technik hergestellt, für Flüssigkristall-Punktmatrixanzeigen, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 60 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 20 × 26 mm. | |

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(Fortsetzung)* | Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>HD 61830<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Kontrollbaustein für Kathodenstrahlröhren (sogenannter Cathode Ray Tube Controller/CRTC) in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 25 × 62 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>AM 8052<br>D 8275 H<br>P 8275 H<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 7 |
| ex 85.21 D II | Video-Digital-Analog-Umsetzer (sogenannter Video-Digital-Analog-Converter/VDAC), mit einer Signalumsetzungszeit von nicht mehr als 10 Nanosekunden, in Form einer hybriden integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 20 × 35 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>VDAC 0405 H<br>VDAC 0605 H<br>VDAC 0805 H<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Video-Digital-Analog-Umsetzer der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Mikroprozessor zur Steuerung der Ein- und Ausgaben (sogenannter Input/Output Microprocessor) in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 53 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>8089<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Mikroprozessoren der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Interpolations-Baustein (sogenannter Interpolation Pulse Generator) zur Steuerung geometrischer Funktionen, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>KM 3701<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Interpolations-Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II | Statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannte C-MOS-RAMs, statisch), mit einer Speicherkapazität von 32 Kbit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 18 × 39 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>TC 5532<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Baustein zur Steuerung von Servovorrichtungen in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 54 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen-/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>KM 3702<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Steuerbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Baustein zur Erzeugung variabler Wellenformen in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 16 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 10 × 21 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>XR 2206<br>XR 8038<br>oder<br>— eine Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Video-Verstärkerbaustein in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 44 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 17 mm, zum Herstellen von tragbaren Farbfernsehkameras (a).<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>702<br>703<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Verstärkerbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Baustein zur Verstärkung entweder der Lese- oder der Schreibsignale von flexiblen Magnetplatten, in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 22 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 11 × 29 mm. | |

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(Fortsetzung)* | Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>XR 2247<br>XR 3470<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Baustein zur Blenden- und Farbtemperaturausgleichsteuerung in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 44 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 17 mm, zum Herstellen von tragbaren Farbfernsehkameras (a).<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>704<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Taktgeber in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten digitalen Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 25 × 25 mm, zum Herstellen von tragbaren Farbfernsehkameras (a).<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>705<br>706<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Taktgeber der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in bipolarer Technik hergestellt (sogenannte bipolare RAMs, statisch), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, bestehend aus einer Substratebene mit 1 oder 2 Chips mit einer Speicherkapazität von jeweils 1 Kbit in einem Gehäuse mit nicht mehr als 23 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 13 × 13 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>770639, 770823, 5120360, 7379769<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in bipolarer Technik hergestellt (sogenannte bipolare RAMs, statisch) in Form von monolithischen integrierten Schaltungen, bestehend aus 2 übereinander angeordneten Substratebenen mit 1 oder 2 Chips mit einer Speicherkapazität von jeweils 1 Kbit und einer Gesamtspeicherkapazität von nicht mehr als 4 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 23 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 13 × 13 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>770965<br>4599497<br>7379442<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II | Programmierbarer Signalsynthetisator (sogenannter Digital Signal Synthesizer) in C-MOS-Technik hergestellt, mit 32 Frequenzgeneratoren zur Erzeugung von jeweils 8 Tönen und einem gleichzeitigen Output von bis zu 160 Tönen, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 25 × 25 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>MEG<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Signalsynthetisatoren der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Baustein zur Regeneration pulscode-modulierter Signale, in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 16 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 10 × 21 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>XR C 240<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Kontrollbaustein in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, zur Steuerung dynamischer Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM, dynamisch), mit Adressen-Multiplexer und Zeitgeber, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 48 oder 52 Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 62 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>C 8208 THCT 4502<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | C-MOS-Uhren/Datum-Schaltungen mit Quarzschwinger, unabhängigen Zeitzählregistern und einem Taktgeber, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 16 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 7 × 20 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>MM 58174 A, 58274<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Uhrenschaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Sendeempfangsbaustein für asynchrone Daten (sogenanntes Asynchronous Communication Element) in MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 54 mm. | |

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(Fortsetzung)* | Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>INS 8250 NS 16450<br>WD 8250 NS 16 C 450<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Sendeempfangsbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Dynamische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt (sogenannte N/H-MOS-RAMs, dynamisch), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 64 K × 4 bit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 20 parallelen Anschlußstiften oder Kontaktflächen (Dual-in-Line) und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 34 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen-/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>TMS 4464, PD 41254, PD 41464, TMM 41464<br>M5M 4464, HM 50464, MB 81464<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf dynamische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 10 |
| ex 85.21 D II | Manchester-Codier- und Decodierbaustein (sogenannter Manchester-Encoder-Decoder/MED) zur kontinuierlichen Datenübertragung, mit Wiederholungsmodus, in C-MOS-Technik hergestellt, mit einer Ausgangsspannung von 4,5 Volt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 20 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 33 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen-/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>HD 6409<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Codier- und Decodierbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Programmierbare UV-löschbare Lesespeicher (sogenannte EPROMs), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 512 Kbit, in einem Gehäuse mit den Abmessungen von nicht mehr als 20 × 42 mm und einem Quarzfenster auf der Oberseite.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen-/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>AM 27512<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | TTL-Logikbaustein in bipolarer Technik hergestellt, mit nicht mehr als sechs logischen Funktionen, die voneinander unabhängig und nicht miteinander verbunden sind, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 34 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen-/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>SH 767 369<br>SH 998 088<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Logikbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II | Kontrollbaustein für Zentraleinheiten (sogenannter CPU-Controller), in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 25 × 25 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen-/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>FE 2000<br>L1A0392<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Kontrollbaustein für flexible Magnetplatten (sogenannter Floppy Disc Controller/FDC), in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 48 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 62 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen-/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>FE 2100 MB 89311<br>G 70360-33<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 7 |
| ex 85.21 D II | Monolithische integrierte Schaltung zur Pulscode-Modulation (sogenannte Pulse Code Modulation/PCM) in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, mit Codier-, Decodier- und Filterfunktionen, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 16 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 10 × 23 mm.<br>Das Gerät trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>2916<br>2917<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf integrierte Schaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 7 |
| ex 85.21 D II | Baustein mit 6 Kanälen zur Verstärkung und Umwandlung der Lesesignale und zur Umwandlung der Schreibsignale für Magnetplattenspeicher mit festen Platten (sogenannter Read/Write Data Processor Circuit), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 19 × 38 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen-/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>SSI 540<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf 6-Kanal-Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | 8-Kanal-Steuerbausteine zur Erhaltung einer konstanten elektromagnetischen Andruckskraft, in C-MOS-Technik hergestellt, mit Dioden und 8-bit-Speicher, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 22 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 9 × 28 mm. | |

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(Fortsetzung)* | Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen-/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>UCN 5801<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Steuerbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | 4-Kanal-Steuerbausteine zur Erhaltung einer konstanten elektromagnetischen Andruckskraft, in C-MOS-Technik hergestellt, mit Dioden und 4-bit-Speicher, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 16 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 7 × 22 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen-/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>UCN 5813<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Steuerbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Monolithische integrierte Schaltung zum Abtasten und Verteilen logischer Signale in Fernsprechvermittlungen, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 14 × 53 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen-/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil hat:<br>QMV 16 BW 1<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf integrierte Schaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 7 |
| ex 85.21 D II | Monolithische integrierte Schaltung zur Pulscode-Modulation (sogenannte Pulse Code Modulation/PCM), in C-MOS-Technik hergestellt, mit Codier-, Decodier- und Filterfunktionen, mit einer Datentaktfrequenz von 2,565 Mhz, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 22 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 10 × 28 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen-/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil hat:<br>QMV 81 AD 1<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf integrierte Schaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 7 |
| ex 85.21 D II | Baustein mit 6 Kanälen zur Erzeugung von Schreib- und Lesesignalen für Magnetplattenspeicher mit festen Magnetplatten, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 13 × 13 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen-/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>SSI 117<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf 6-Kanal-Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II | Programmierbare Lesespeicher, nicht löschbar (sogenannte PROMS), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 16 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 32 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen-/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>27 PS 191 A 7 C 245 7 C 292<br>29683 7 C 291 HM 6616<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Verstärker, steuerbar für Signale von 0 bis 60 KHz, und mit einem Reststrom von nicht mehr als 0,3 Mikroampere, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 18 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 6 × 13 × 26 mm, zur Verwendung in Fernsprechanlagen (a).<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen-/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>ISO 100<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Verstärker der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Leuchtdioden, die von Halbleiterteilen aus im wesentlichen Gallium hergestellt sind, in einem Gehäuse mit 2 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 20 × 21 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen-/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>LT 9305 SLF 209<br>LT 9306 SLF 909<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Leuchtdioden der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Ein-Chip-Mikrocomputer, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, bestehend aus einer arithmetischen, logischen Einheit (Rechenwerk) mit einer Kapazität von 4 bit, einem Lesespeicher (sogenannter ROM), mit einer Speicherkapazität von 2 K × 8 bit, einem Doppel-Ton-Multifrequenz (DTMF)-Generator, einem Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Speicherkapazität von 1 Kbit, auch mit einem weiteren Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Speicherkapazität von 512 bit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 42 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 54 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen-/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>T 6978 TCM 8301 TCM 8302<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Ein-Chip-Mikrocomputer der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Asynchrone FIFO (First In/First Out)-Speicher, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung mit einer Speicherkapazität von 64 × 4 bit oder 64 × 5 bit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 18 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 11 × 24 mm. | |

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(Fortsetzung)* | Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen-/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>CY7C401<br>CY7C402<br>CY7C403<br>CY7C404<br>CY 3341<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Speicher der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannter C-MOS-RAMs, statisch) in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 16 × 4 bit und einer Zugriffszeit von nicht mehr als 35 Nanosekunden, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 16 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 9 × 21 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen-/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>CY7C189<br>CY7C190<br>CY74S189<br>CY54S189<br>CY27S03<br>CY27S07<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannte C-MOS-RAMs, statisch), mit einer Speicherkapazität von 256 × 4 bit und einer Zugriffszeit von nicht mehr als 60 Nanosekunden, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 22 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 12 × 29 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen-/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>CY7C122<br>CY 93422/93L422<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Elektrisch löschbare, programmierbare Lesespeicher (sogenannte $E^2$PROMs), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung ohne Gehäuse (Mikroplättchen) mit einer Speicherkapazität von 16 Kbit, zur Verwendung beim Herstellen von mit Mikrowellen arbeitenden Objekt- oder Personenidentifizierungssystemen (a) | 0 |
| ex 85.21 D II | Dynamische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in N-MOS (einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt (sogenannte N/H-MOS-RAMs, dynamisch), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, bestehend aus einer Substratebene mit nicht weniger als 2 und nicht mehr als 8 Chips mit einer Speicherkapazität von jeweils 128, 192 oder 256 Kbit und einer Gesamtspeicherkapazität von nicht weniger als 256 Kbit und nicht mehr als 2 Megabit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 57 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 30 × 30 mm. | |

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(Fortsetzung)* | Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>6025841 6031587 6870392 7379172<br>6025843 6031591 6870393 7379174<br>6025856 6870395 7379176<br>6025858 7379181<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf dynamische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Dynamische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff und dualer Ein-/Ausgangsstelle in N-MOS (einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt (sogenannte N/H-MOS-RAMs, dynamisch), mit Datenregister und serieller Leseausgangskontrolle, mit einer Speicherkapazität von 256 Kbit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 13 × 39 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>PD 41264 MB 81461<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Bus-Schnittstellenbaustein zur Kontrolle der Übertragungsleitungen in C-MOS-Technik hergestellt, bestehend aus einem numerischen Bus, zwei unabhängigen Empfängern und einem Sender mit FIFO (First In/First Out)-Speicher, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 15 × 50 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>HS 3282<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Monolithische integrierte Schaltung in N-MOS (einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, zum Erzeugen von graphischen Symbolen auf einem Kathodenstrahl-Bildschirm in Vektor-Schreibweise, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 28 × 61 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>FCD 28 042 277, 96 114 899, 96 149 135, 96 114 898<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in ECL-Technik hergestellt (sogenannte ECL-RAMs), mit einer Speicherkapazität von 256 × 4 bit und einer Zugriffszeit von nicht mehr als 8 Nanosekunden, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 11 × 32 mm. | |

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(Fortsetzung)* | Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>10422 10422 A<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannte C-MOS-RAMs, statisch), mit einer Speicherkapazität von 256 Kbit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>HM 62256 PD 43256 C TC 55257 P<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in ECL-Technik hergestellt (sogenannte ECL-RAMs) mit einer Speicherkapazität von 16 Kbit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 20 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 9 × 27 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>10480<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Oktal-Treiberbaustein (sogenannter Eight-Line-Driver) in TTL-Schottky-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 14 × 14 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>5170 NE 5170 UC 5170<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Treiberbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Oktal-Empfangsbaustein (sogenannter Eight-Line-Receiver) in TTL-Schottky-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 14 × 14 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>5180 NE 5180 5181<br>NE 5181 8510 8511<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Empfangsbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II | Schnittstellenbaustein zur Datenstromsynchronisierung von festen Magnetplatten, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 35 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>DP 8462<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Datentrennbaustein für feste Magnetplatten (sogenannter Hard Disc Data Separator/HDDS), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 37 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>DP 8465 WD 10 C 20<br>DP 8460-2<br>DP 8460-3<br>DP 8460-4<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Datentrennbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Hybride integrierte Schaltung zum Steuern von Elektromagneten, bestehend aus vier Darlington-Transistoren (ein Darlington = 2 Transistoren in Kaskadenschaltung), in einem Gehäuse mit nicht mehr als 10 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 12 × 27 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>TH 3L10<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf integrierte Schaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Schnittstellenbaustein, in C-MOS-Technik hergestellt, für den peripheren Festmagnetplattenspeicher und der Zentraleinheit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 28 × 53 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>OMTI 508 AIC 500<br>OMTI 509 AIC 16000<br>WD 11 C 00<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Baustein zur Folgekontrolle der Daten zwischen Festmagnetplattenspeicher und Speicherkontrolleinheit, in MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 28 × 28 mm. | |

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(Fortsetzung)* | Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>AIC 010<br>OMTI 5050<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Serienschnittstellenbaustein zur Datenstromcodierung und -decodierung für Festmagnetplattenspeicher, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 37 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>OMT 5070 OMT 5027<br>AIC-250 AIC-270<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Kontrollbaustein in MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, zur Steuerung statischer Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM, statisch), mit Adressen-Multiplexer und Zeitgeber, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 28 × 28 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>OMTI 506 AIC 300<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Monolithische integrierte Schaltung zur Pulscode-Modulation (sogenannte Puls Code Modulation/PCM) in N-MOS (einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, bestehend aus einer Tastspeicherschaltung (sogenannter Sample and Hold Circuit), Digital-Analog-Umsetzer, Grenzwertangleicher, Register für sukzessive Approximation, logischer Funktion für eine Schnittstelle zu einer PCM-Linie zur gleichzeitigen Datenübermittlung in beiden Richtungen (Full Duplex), in einem Gehäuse mit nicht mehr als 22 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 11 × 28 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>2911A-1<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf integrierte Schaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 7 |
| ex 85.21 D II | Sendeempfangsfilter zur Pulscode-Modulation (sogenannte Pulse Code Modulation/PCM) in N-MOS (einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, für einen PCM-Leitungsanschluß, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 16 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 10 × 21 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>D 2912 A<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Sendeempfangsfilter der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 7 |

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II | Dynamische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff, in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannte C-MOS-RAMs, dynamisch), mit einer Speicherkapazität von 256 Kbits, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 18 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 34 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>P 51 C 256<br>P 51 C 259<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf dynamische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Kontrollbaustein für Kathodenstrahlröhren (sogenannter Cathode Ray Tube Controller/CRTC), in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 15 × 55 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>SCB 2675<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Programmierbare Lesespeicher, nicht löschbar (sogenannte PROMs), mit einer Speicherkapazität von 32 Kbit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 32 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält:<br>63S3281 AM 27S43<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |
| ex 85.21 D II | Kontrollbaustein für Videoanzeigen (sogenannter Advanced Video Display Controller/AVDC) in N-MOS (einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 15 × 55 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>SCN 2674<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 7 |
| ex 85.21 D II | Kontrollbaustein zum Steuern magnetischer Drucktypen, in TTL-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 16 Anschlußstiften und nicht mehr als 7 × 20 mm.<br>Das Gehäuse trägt<br>— eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält:<br>801379-002<br>oder<br>— eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. | 0 |

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 85.21 E | Kathodenstrahlröhren-Ablenkeinheiten für Frequenzen von nicht weniger als 31 250 und nicht mehr als 64 000 Hz, mit einem 4-Pol-Magneten | 0 |
| ex 85.23 B | Isolierter Wickeldraht, weder lackiert noch verniert, aus Aluminium mit einer Reinheit von 99,5 Gewichtshundertteilen oder mehr, mit einer Gesamtdicke von nicht weniger als 0,15 und nicht mehr als 0,16 mm | 0 |
| ex 90.02 B | Lichtwellenumkehrleiter aus optischen Fasern | 0 |
| ex 90.02 B | Regelbares Objektiv mit einer Brennweite von nicht weniger als 115 und nicht mehr als 140 mm, bestehend aus 4 bis 8 Linsen aus Glas oder Methacrylat, die einen Durchmesser von nicht weniger als 120 und nicht mehr als 130 mm aufweisen und jeweils auf mindestens einer Seite mit Magnesiumfluorid beschichtet sind, zum Einbau in Videoprojektoren (a) | 0 |
| ex 90.02 B | Optisches Element, bestehend aus zwei Lagen starrer, optischer Fasern zwischen zwei Kunststoffplatten, mit den Abmessungen von nicht mehr als 276 × 20 × 5 mm, zum Herstellen von Photokopierapparaten (a) | 0 |
| ex 90.10 A | Optische Einheit für Photokopierapparate, bestehend aus zwei Lagen starrer, optischer Fasern zwischen zwei Kunststoffplatten, einer röhrenförmigen Lampe und einem Metallreflektor, auf einem metallischen Halter mit den Abmessungen von nicht mehr als 335 × 100 × 40 mm | 0 |
| ex 90.10 A | Einheit für Photokopierapparate, bestehend aus einer Halogenlampe und einem Metallreflektor, jedoch ohne optisches Element, auf einem metallischen Halter mit den Abmessungen – ohne Kabel und Anschlußstücke – von nicht mehr als 290 × 112 × 53 mm | 0 |
| ex 90.19 B II | Tragbare Lesevorrichtung für hochgradig Sehbehinderte, bei der eine von Hand zu führende Fiberoptik-Kamera Dokumente abtastet und ein vergrößertes Bild auf einen Bildschirm überträgt, und ihre Teile | 3 |

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

TABELLE II

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 27.07 A I | Rohe Leichtöle mit einem Gehalt an:<br>— Vinyltoluol von nicht weniger als 10 Gewichtshundertteilen,<br>— Inden von nicht weniger als 10 Gewichtshundertteilen,<br>— Naphtalin von nicht weniger als 1 und nicht mehr als 5 Gewichtshundertteilen | 0 |
| ex 27.10 B III | Mischung von Kohlenwasserstoffen mit einem Gehalt an linearen $C_8$-bis $C_{16}$-Paraffinen von 85 Gewichtshundertteilen oder mehr und an Alkylbenzolen mit einer linearen Kettenlänge von 10 bis 12 Kohlenstoffatomen von 13 Gewichtshundertteilen oder weniger | 0 |
| ex 27.13 B II | 1-Alkene mit einer Kettenlänge von nicht weniger als 18 und nicht mehr als 30 Kohlenstoffatomen | 0 |
| ex 28.04 B | Helium | 0 |
| ex 28.05 C I | Legierung aus Cer und anderen Metallen der Seltenen Erden mit einem Gehalt an Cer von 47 Gewichtshundertteilen oder mehr | 0 |
| ex 28.13 IJ | Tellurdioxid | 0 |
| ex 28.14 B | Jodpentafluorid | 0 |
| ex 28.21 | Chromdioxid | 0 |
| ex 28.22 B | Manganoxid mit einem Gehalt an Mangan von 77 Gewichtshundertteilen oder mehr | 0 |
| ex 28.39 A | Kaliumnitrit zum Herstellen von Kühl- und Schneidflüssigkeiten zur Verwendung bei der Bearbeitung von Metallen oder Hartmetallen (a) | 0 |
| ex 28.40 B II | Pentacalciumhydroxidtris (orthophosphat) bestimmt zur Verwendung in der NE-Metallurgie (a) | 0 |
| ex 28.42 A VI | Andere Lithiumcarbonate als solche:<br>— in Form von weißem Pulver mit einem Gehalt an $Li_2CO_3$ von 98,5 % oder mehr und<br>— an Arsen von weniger als 2 ppm<br>— an Calcium von weniger als 200 ppm<br>— an Chlor von weniger als 200 ppm<br>— an Eisen von weniger als 20 ppm<br>— an Magnesium von weniger als 150 ppm<br>— an Schwermetallen von weniger als 20 ppm<br>— an Kalium von weniger als 300 ppm<br>— an Natrium von weniger als 300 ppm<br>— an Sulfaten von weniger als 200 ppm | 0 |
| 28.46 A I b) | Wasserfreie Natriumborate | 0 |
| ex 28.46 A II | Dinitriumtetraboratpentahydrat | 0 |

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 28.47 F | Calciumwolframat zum Herstellen von Ferrolegierungen oder Decaammonium-4l-oxododeca-wolframat (Ammoniumparawolframat) (a) | 0 |
| ex 28.48 B III | Hydrotalcit (INN) | 0 |
| ex 28.49 C II<br>und/oder<br>ex 30.03 A II b) | Carboplatin (INN) | 0 |
| 28.51 A | Deuterium, Deuteriumoxid (schweres Wasser) und andere Deuteriumverbindungen; Wasserstoff und seine Verbindungen, mit Deuterium angereichert; Mischungen und Lösungen, die diese Erzeugnisse enthalten (EURATOM) | 0 |
| ex 29.01 C I | *beta*-Pinen | 0 |
| ex 29.01 D VII | Vinyltoluole | 0 |
| ex 29.01 D VII | Tricyclo [8.2.2.2$^{4,7}$] hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexaen | 0 |
| ex 29.01 D VII | *P*-Cymol | 0 |
| ex 29.02 A I | Kohlenstofftetrafluorid (Tetrafluormethan) | 0 |
| ex 29.02 A III | Vinylbromid | 0 |
| ex 29.02 A III | 1,2-Dibromäthan | 4 |
| ex 29.02 A V | Bromchlormethan | 0 |
| ex 29.02 B | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachlorpentracyclo [12.2.-1.1.$^{6\cdot9}$.0$^{2\cdot13}$.0$^{5\cdot10}$] octadeca-7,15-dien, zur Verwendung bei der Herstellung von Polyamid (a) | 0 |
| ex 29.02 C | Di- oder Tetrachlortricyclo [8.2.2.2$^{4\cdot7}$] hexadeca-1 (12),4,6,10,13,15-hexaen-Isomerengemisch | 0 |
| ex 29.03 A | Methansulfonsäure | 0 |
| ex 29.03 B II | Nitromethan | 0 |
| ex 29.03 B II | 1-Nitropropan | 0 |
| ex 29.03 B II | 2-Nitropropan | 0 |
| ex 29.03 B II | Nitroäthan | 0 |
| ex 29.03 C I | Methansulfonylchlorid | 0 |

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 29.03 C I | 2,2,2-Trifluoräthyltrichlormethansulfonat | 0 |
| ex 29.04 C I | Butan-1,3-diol | 0 |
| ex 29.04 C I | 2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yn-4,7-diol | 0 |
| ex 29.04 C I | Hexan-1,6-diol | 0 |
| ex 29.04 C V | 2,2-Bis(brommethyl)propandiol | 0 |
| 29.05 A II | Menthol | 0 |
| ex 29.05 A IV | Labd-14-en-8,13-diol | 0 |
| ex 29.06 A IV | 2-Isopropylphenol | 0 |
| ex 29.06 B V | 4,4′-(2,3-Dimethyltetramethylen)dipyrocatechol mit einem Reinheitsgrad von 98 Gewichtshundertteilen oder mehr | 0 |
| ex 29.06 B V | 6,6′,6″-Tri-*tert*-butyl-4,4′,4″-(1-methylpropan-1-yl-3-yliden)tri-*m*-kresol, auch Toluol aus der Kristallisation enthaltend | 0 |
| ex 29.06 B V | 2,5-Di(*tert*-pentyl)hydrochinon | 0 |
| ex 29.07 A | 4,4′ -(Perfluorisopropyliden)diphenol | 0 |
| ex 29.07 C III | 2,4-Dinitro-6-octylphenol | 0 |
| ex 29.08 A III c) | 2-Brom-6-methoxynaphthalin | 0 |
| ex 29.08 A III c) | Bis(phenoxyphenoxy)benzol-Isomerengemisch | 0 |
| ex 29.08 A III c) | 1,2-bis(2,4,6-tribromphenoxy)äthan zum Herstellen von Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) (a) | 0 |
| ex 29.08 B I | 3,3′ -Oxydi(propylenglykol) | 0 |
| ex 29.08 B I | 2-(2-Chloräthoxy)äthanol | 0 |
| ex 29.08 B II | 2,2′ -[Isopropylidenbis(2,6-dibrom-4,1-phenylenoxy]diäthanol | 0 |
| ex 29.13 A I | 5-Methylhexan-2-on | 0 |
| ex 29.13 A I | 3,3-Dimethylbutanon | 0 |

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 29.13 B I b) | Bornan-2-on (Kampfer), natürliches, raffiniert | 0 |
| ex 29.13 D I b) | 11-*alpha*, 17,21-Trihydroxy-16-*beta*-methylpregna-1,4-dien-3,20-dion | 0 |
| ex 29.13 E | 4-Methoxy-4 methylpentan-2-on | 0 |
| ex 29.13 E | 6′ -Methoxy-2′ -propiononaphthon | 0 |
| ex 29.13 F | 1,4-Naphthochinon | 0 |
| ex 29.13 F | Ubidecarenon (INN) (Coenzym $Q_{10}$) | 0 |
| ex 29.13 G II | 1-Chlor-3,3-dimethylbutanon | 0 |
| ex 29.14 A II c) 4 | 20-Oxopregna-5,16-dien-3-*beta*-ylacetat | 0 |
| ex 29.14 A VII | 1-Isopropyl-2,2-dimethyltrimethylendiisobutyrat | 0 |
| ex 29.14 B IV b) | Methacryloylchlorid | 0 |
| ex 29.14 B IV b) | Butylperchlorcrotonat | 0 |
| 29.15 A IV a) | Azelainsäure, Sebacinsäure | 0 |
| ex 29.15 A V | Natrium-1,2-bis(cyclohexyloxycarbonyl)äthansulfonat | 0 |
| ex 29.15 C III | Benzol-1,2,4-tricarbonsäure | 0 |
| ex 29.15 C III | Benzol-1,2,4-tricarbonsäure-1,2-anhydrid | 0 |
| ex 29.15 C III | Tetrachlorphtalsäureanhydrid | 0 |
| ex 29.15 C III | Tetrabromphthalsäureanhydrid | 0 |
| ex 29.15 C III | Benzol-1,2,4-tricarbonyltrichlorid | 0 |
| ex 29.16 A II | Apfelsäure und ihre Salze, mit einem L-Isomergehalt von 94 % oder mehr | 0 |
| ex 29.16 A VIII a) | 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionsäure | 0 |
| ex 29.16 B VI | Octadecyl-3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat | 0 |
| ex 29.16 B VI | Pentaerythrittetrakis[-3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat] | 0 |
| ex 29.16 D | Dinoproston (INN) | 0 |

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 29.16 D | Alprostadil (INN) | 0 |
| ex 29.16 D | 2,6-Dimethoxybenzoesäure | 0 |
| ex 29.19 C | 2,2-Bis(chlormethyl)trimethylentetrakis-(2-chloräthyl)bis(phosphat) | 5 |
| ex 29.21 A | Diäthylsulfat | 0 |
| ex 29.21 B II | *0,0'*-Bis(2,4-di-*tert*-butylphenyl)pentaerythritbis(phosphit) | 0 |
| ex 29.21 B II | 0,0' -Dioctadecylpentaerythritbis(phosphit) | 0 |
| ex 29.22 A III | *tert*-Butylamin | 0 |
| ex 29.22 A III | 1,1,3,3-Tetramethylbutylamin | 0 |
| ex 29.22 B II | *N,N,N',N'*-Tetrabutylhexamethylendiamin | 0 |
| ex 29.22 C II | Cyclohex-1,3-ylendiamin (1,3-diaminocyclohexan) | 0 |
| ex 29.22 D IV | *alpha', alpha' alpha'*-Trifluor-2,3-xylidin | 0 |
| ex 29.22 E II | *m*-Phenylenbis(methylamin) | 0 |
| ex 29.22 E II | 1,8-Naphthylendiamin | 0 |
| ex 29.23 A II | Trometamol(INN)-salz des Dinoprosts (INN) | 0 |
| ex 29.23 A II | (+)-4-Dimethylamino-3-methyl-1,2-diphenylbutan-2-ol | 0 |
| ex 29.23 A II | 1-Desoxy-1-(octylamino)*D*-sorbit | 0 |
| ex 29.23 B II | Dobutamin (INN) und seine Salze | 0 |
| ex 29.23 C und ex 30.03 A II b) | Ketamin-Hydrochlorid (INNM) | 0 |
| ex 29.23 D V | Tranexamsäure (INN) | 0 |
| ex 29.23 D V | *beta*-Alanin | 0 |
| ex 29.23 E | Metipranolol (INN) | 0 |
| ex 29.23 E | Diäthyl-1,3-benzodioxol-5-ylaminomethylenmalonat | 0 |

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 29.23 E | Levodopa (INN) | 0 |
| ex 29.23 E | Nadolol (INN) | 0 |
| ex 29.23 E | Methyldopa (INN) | 0 |
| ex 29.23 E | Indenololhydrochlorid (INN) | 0 |
| ex 29.23 E | Glucosamin-Hydrochlorid (INNM) | 0 |
| ex 29.25 A II | (3-Methacrylamidopropyl)trimethylammoniumchlorid | 0 |
| ex 29.25 A II | 2-Acrylamido-2-methylpropansulfronsäure und ihre Natrium- oder Ammoniumsalze | 0 |
| 29.25 B II a) | Phenobarbital (INN) und seine Salze | 11 |
| ex 29.25 B III b) | Bendiocarb (ISO) | 0 |
| ex 29.25 B III b) | Flutamid (INN) | 0 |
| ex 29.26 A II | 3,3′,4′,4′,5,5′,6,6′-Octabrom *N.N′*-äthylendiphthalimid | 0 |
| ex 29.27 | (–)-*N*-(*alpha*-Cyano-4-hydroxy-3-methoxy-*alpha*-methyl-phenethyl)acetamid | 0 |
| ex 29.27 | 2-(3-Phenoxyphenyl)propiononitril | 0 |
| ex 29.27 | Isophthalnitril | 6 |
| ex 29.29 | 20-Hydroxyiminopregna-5,16-dien-3-ylacetat | 0 |
| ex 29.29 | Carbidopa (INN) | 0 |
| ex 29.29 | Robenidin-Hydrochlorid (INNM) | 0 |
| ex 29.29 | *N,N*-Diäthylhydroxylamin | 0 |
| ex 29.29 | 3,3′-Bis(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl)-*N,N′*-bipropionamid | 0 |
| ex 29.29 | 2,4,6-Trichlorphenylhydrazit | 0 |
| ex 29.30 | *0,0*-Bis(4-*tert*-butylphenyl)-*N*-cyclohexyl-phosphor-amidothioat | 0 |
| ex 29.30 | Methylendicyclohexyldiisocyanat-Isomerengemisch | 0 |
| ex 29.30 | *para*-Phenylendiisocyanat | 0 |

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 29.30 | *trans*-(Cyclohex-1,4-ylendiisocyanat) zum Herstellen von thermoplastischen Polyurethan-Elastomeren (a) | 0 |
| ex 29.30 | 3,3'-Dimethylbiphenyl-4,4'-diyldiisocyanat | 0 |
| ex 29.31 B | Thiophenol | 0 |
| ex 29.31 B | 2,2'-Thiodiäthylbis[3-C(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat] | 0 |
| ex 29.31 B | Probucol (INN) | 0 |
| ex 29.31 B | Ethoprophos (ISO) | 0 |
| ex 29.31 B | Cilastatin-Natrium (INNM) | 0 |
| ex 29.34 C | Kristallines Dimethyl-Zinndichlorid in Form von Pulver, zum Herstellen von Waren des Kapitels 70 (a) | 0 |
| ex 29.34 C | 2-Chloräthylphosphonsäure | 3,8 |
| ex 29.34 C | Chlordiphenylphosphin | 0 |
| ex 29.34 C | 2-Diphenylphosphinobenzoesäure | 0 |
| ex 29.35 Q | Octrizol (INN) | 0 |
| ex 29.35 Q | Drometrizol (INN) | 0 |
| ex 29.35 Q | 2,6-di-*tert*-butyl-4-[4,6-bis(ocylthio)-1,3,5-triazin-2-ylamino]phenol | 0 |
| ex 29.35 Q | Timolol (INN) | 0 |
| ex 29.35 Q | Clotiazepam (INN) | 0 |
| ex 29.35 Q | 1,4-Diazabicyclo(2,2,2)octan (Triäthylendiamin) | 0 |
| ex 29.35 Q | 2,4-di-*tert*-butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol | 0 |
| ex 29.35 Q | Carpipramin-Dihydrochlorid (INNM) | 0 |
| ex 29.35 Q | 2,3-Dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-ol | 0 |
| ex 29.35 Q | 1-Äthyl-1,4-dihydro-4-oxo(1,3)dioxol[4,5-g]cinnolin-3-carbonitril | 0 |
| ex 29.35 Q | Diphemanilmethylsulfat (INN) | 0 |

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 29.35 Q | (25 *R*)-Spirost-5-en-3-*beta*-ol(Diosgenin) und seine Ester | 0 |
| ex 29.35 Q | Azatadin-Dimaleat (INNM) | 0 |
| ex 29.35 Q | Amprolium-Hydrochlorid (INNM) | 0 |
| ex 29.35 Q | 2-(4-Pyridyl)äthansulfonsäure | 0 |
| ex 29.35 Q | Prifiniumbromid (INN) | 0 |
| ex 29.35 Q | Glucurolacton (INN) | 0 |
| ex 29.35 Q | 2-Chlordibenz [*bf*][*1,4*]oxazepin-11(10*H*)-on | 0 |
| ex 29.35 Q | 2,3,5,6-Tetrachlorpyridin | 0 |
| ex 29.35 Q | Diltiazem-Hydrochlorid (INNM) | 0 |
| ex 29.35 Q | (6*R*,7*R*)-3-Acetoxymethyl-7-[(*R*)-2-formyloxy-2-phenylacetamid]-8-oxo-5-thia-l-azabicyclo[4,2.0]oct-2-en-2-Carbonsäure und ihre Salze und Ester | 0 |
| ex 29.35 Q | 5-Brompyrimidin | 0 |
| ex 29.35 Q | Minoxidil (INN) | 0 |
| ex 29.35 Q | Triazolam (INN) | 0 |
| ex 29.35 Q | Diazoxid (INN) | 0 |
| ex 29.35 Q | Captopril (INN) | 0 |
| ex 29.35 Q | Flunixin-Meglumin (INNM) | 0 |
| ex 29.35 Q | Tryptophan | 0 |
| ex 29.35 Q | Alprazolam (INN) | 4,5 |
| ex 29.35 Q | Lasalocid-Natrium (INNM) | 0 |
| ex 29.35 Q | 1-Hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-methoxycarbonyl-1-naphthyl)-3-oxo-*1 H, 3 H*-benzo[*de*]isochromen-1-yl]-6-octadecyloxy-2-naphthoesäure | 0 |
| ex 29.35 Q | Isonicotinnitril | 0 |
| ex 29.35 Q | 3,6-Dichlorpyridin-2-carbonsäure | 3 |

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 29.35 Q | 2-Hydroxyäthylammonium-3,6-dichlorpyridin-2-carboxylat | 3 |
| ex 29.35 Q | Bis(2-hydroxyäthyl) (9,10-dihydro-10-oxo-9-oxa-10 *lambda*$^{5}$-phospha-10-phenanthrylmethyl)succinat | 0 |
| ex 29.35 Q | 13,14,15,16-Tetranorlabdan-12,8*alpha*-lacton | 0 |
| ex 29.35 Q | 5-Nitrofurfurylidendi (acetat) | 0 |
| ex 29.35 Q | Tetrahydrofuran, nicht mehr als 40 mg/Liter an Tetrahydro-2-methylfuran und an Tetrahydro-3-methylfuran insgesamt enthaltend, zum Herstellen von *alpha*-4-Hydroxybutyl-*omega*-hydroxypoly(oxytetramethylen) (a) | 0 |
| ex 29.35 Q | Estazolam (INN) | 0 |
| ex 29.35 Q | Timepidiumbromid (INN) | 0 |
| ex 29.35 Q | Adenosinphosphat (INN) | 0 |
| ex 29.35 Q | 3-(1-Äthyl-1-methylpropyl)isoxazol-5-ylamin | 0 |
| ex 29.35 Q | 4,4′-Bis(hydroxyiminomethyl)-1,1′-(oxydimethylen) dipyridinium dichlorid | 0 |
| ex 29.35 Q | *(RS)*-1-[2-(4-Chlorbenzhydryloxy)äthyl]piperidin und seine Salze | 0 |
| ex 29.35 Q | 4-(2-Aminoäthylthiomethyl)-1,3-thiazol-2-ylmethyldimethylamin | 0 |
| ex 29.35 Q und ex 30.03 A II b) | Butorphanol (INN) und seine Salze | 0 |
| ex 29.35 Q und ex 30.03 A II b) | Buspiron-Hydrochlorid (INNM) | 0 |
| ex 29.35 Q und ex 30.03 A II b) | Encainid-Hydrochlorid (INNM) | 0 |
| ex 29.35 Q und ex 30.03 A II b) | Tegafur (INN) | 0 |
| ex 29.36 | 3-[1(7-Hexadecan-1-sulfamidindol-3-yl)-3-oxo-1*H*, 3*H*-benzo—[de]isochromen-l-yl]indol-7-carbonsäure | 0 |
| ex 29.36 | Quinethazon (INN) | 0 |
| ex 29.36 | Sulfaguanidin (INN) | 0 |
| ex 29.36 | Sulfathiazol (INN) | 0 |
| ex 29.36 | 4-Chlor-,5-sulfamoylanthranil-*o*-toluidid | 0 |

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 29.37 | (2,3-Dihydro-3-oxobenz[*d*]isothiazol-2-yl)-*N*-5-methylisososoxazol-3-ylacetamid-*S*,*S*-dioxid | 0 |
| ex 29.38 A | Nicotinsäure (INN) | 0 |
| ex 29.38 B II | Dexpanthenol (INN) | 0 |
| ex 29.38 B III | Folsäure (INN) | 0 |
| ex 29.38 B V | Nicotinamid (INN) | 0 |
| ex 29.39 C I | Serumgonadotrophin (INN) | 0 |
| ex 29.39 D II | 17,21-Betamethasondipropionat (INNM) | 0 |
| ex 29.39 D II | Diflorasondiacetat (INNM) | 0 |
| ex 29.39 D II | Alclometason-17,21-dipropionat (INNM) | 0 |
| ex 29.39 E | Lachs-Calcitonin (INN) und seine Salze | 0 |
| ex 29.39 E | Prasteron (INN) | 0 |
| ex 29.39 E | Calcitonin (INN) von Schweinen | 0 |
| 29.42 C I | Koffein und seine Salze | 4,1 |
| ex 29.42 C VII | Vindesin-Sulfat (INNM) | 0 |
| ex 29.43 B | Ribose | 0 |
| ex 29.43 B | Sucralfat (INN) | 0 |
| ex 29.43 B | Saccharosebenzoat mit einer Verseifungszahl von 175 oder weniger | 0 |
| ex 29.44 A | Epicillin (INN) | 0 |
| ex 29.44 A | Piperacillin (INN) | 0 |
| ex 29.44 A und ex 30.03 A II a) 1 | Piperacillin-Natrium (INNM) | 0 |
| ex 29.44 C | Amphotericin B (INN) | 0 |
| ex 29.44 C | Minocyclin (INN) und seine Salze | 0 |
| ex 29.44 C | Clindamycin (INN) und seine Salze und Ester | 0 |

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 29.44 C | Spectinomycin-Dihydrochloridpentahydrat (INNM) | 0 |
| ex 29.44 C | Nystatin (INN) | 0 |
| ex 29.44 C | Sisomycin-Sulfat (INNM) | 0 |
| ex 29.44 C | Spectinomycin-Sulfat (INNM) | 0 |
| ex 29.44 C | Tobramycin (INN) und seine Salze | 0 |
| ex 29.44 C | Lincomycin (INN) und seine Salze und Ester, zum Herstellen von Arzneiwaren der Tarifnummer 30.03 (a) | 0 |
| ex 29.44 C | Monensin (INN) und seine Salze | 0 |
| ex 29.44 C | Cefachlor (INN) und seine Salze, Hydrate und Ester | 0 |
| ex 29.44 C | Netilmicin-Sulfat (INNM) | 0 |
| ex 29.44 C | Dibekacin-Sulfat (INNM) | 0 |
| ex 29.44 C | Cefoxitin-Natrium (INNM) | 0 |
| ex 29.44 C | Cefradin (INN) | 0 |
| ex 29.44 C | Cefazolin (INN) und seine Salze | 0 |
| ex 29.44 C | Latamoxef (INN) und seine Salze und Ester | 0 |
| ex 29.44 C | Josamycin (INN) | 0 |
| ex 29.44 C | Josamycinpropionat (INNM) | 0 |
| ex 29.44 C | Ribostamycin-Sulfat (INNM) | 0 |
| ex 29.44 C | Fumagillin-Dicyclohexylammonium (INNM) | 0 |
| ex 29.44 C | Ceftezol (INN) | 0 |
| ex 29.44 C | Aztreonam (INN) | 0 |
| ex 29.44 C | Imipenem (INN) | 0 |
| ex 29.44 C | Cefotetan (INN) | 0 |

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 29.44 C | Ceftizoxim-Natrium (INNM) | 0 |
| ex 29.44 C | Midecamycin (INN) und seine Acetate | 0 |
| ex 29.44 C | Neomycinsulfat (INNM) | 0 |
| ex 29.44 C und ex 30.03 A II b) | Amikacin (INN) und seine Salze | 0 |
| ex 29.44 C und ex 30.03 A II b) | Mitomycin (INN) | 0 |
| ex 29.44 C und ex 30.03 A II b) | Bleomycin-Sulfat (INNM) | 0 |
| ex 29.44 C und ex 30.03 A II b) | Aclarubicinhydrochlorid (INNM) | 0 |
| ex 29.45 | Kalium-*tert*-butylat | 0 |
| ex 30.02 A | Tetanus-Immunglobulin | 0 |
| ex 30.02 A | Tetanus-Immunplasma | 0 |
| ex 30.02 A | Keuchhusten-Immunplasma | 0 |
| ex 30.02 A | Tollwut-Immunplasma | 0 |
| ex 30.03 A II b) | Gemisch aus Pferdeöstrogenen, in Form von Pulver | 0 |
| ex 30.03 A II b) | Gemisch aus Cefradin (INN) und Arginin (INN) | 0 |
| ex 30.03 A II b) und B II b) | Humanalbumin, auch als Lösung | 0 |
| ex 30.03 A II b) und B II b) | Serumkonserven, aus menschlichem Blut gewonnen | 0 |
| ex 30.03 A II b und B II b) | Antihämophiles Globulin und Anti-$Rh_o$(D)-Globulin, aus menschlichem Blut gewonnen | 0 |
| ex 30.03 A II b und ex 30.03 B II b) | Gammaglobulin, in Lösung, aus menschlichem Blut gewonnen | 0 |
| ex 30.03 B II b) | Gammaglobulin, lyophilisiert, aus menschlichem Blut gewonnen | 0 |
| ex 30.03 B II b) | Gereinigtes Kollagen, dispergiert in einem Phosphatpuffer einer physiologischen Salzlösung, auch Lidocain (INN) enthaltend | 5 |

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| 32.01 A I | Mimosaauszug | 0 |
| ex 32.01 A IV | Gerbstoffauszüge aus Gambir und Myrobalanenfrüchten | 0 |
| ex 32.01 A IV | Gerbstoffauszüge aus Eukalyptus | 3,2 |
| ex 32.08 D | Glas in Form von Flocken mit einer Länge von nicht weniger als 0,1 und nicht mehr als 3,5 mm und einer Dicke von nicht weniger als 2 und nicht mehr als 5 Mikrometer | 0 |
| ex 32.08 D | Glas in Form von Pulver oder Granalien, mit einem Gehalt an Siliciumdioxid von 99 Gewichtshundertteilen oder mehr | 0 |
| ex 34.02 | *alpha*-Methyl-*omega*-hydroxypoly(oxypropylen) mit einem mittleren Molekulargewicht von nicht weniger als 240 und nicht mehr als 260 | 0 |
| ex 34.02 | Gemisch aus Docusat-Natrium (INN) und Natriumbenzoat | 0 |
| ex 35.07 | Bromelaine (INN) | 0 |
| ex 35.07 | Gemisch aus Streptokinase (INN) und Streptodornase (INN) | 0 |
| ex 35.07 | Pyruvat: Oxygen Oxidoreductase | 0 |
| ex 35.07 | Lipoproteinlipase | 0 |
| ex 35.07 | Serrapeptase (INN) | 0 |
| ex 37.02 B | Negativfarbfilme mit einer Breite von nicht mehr als 75 mm und nicht mehr als 105 mm und einer Länge von 100 m oder mehr, zum Herstellen von Sofortbildfilmen (a) | 0 |
| ex 38.03 B | Säureaktivierter Montmorillonit, der in Röntgen-Pulveraufnahmen vier Hauptlinien ergibt, die den Netzebenenabständen (d-Werte) 0,44, 0,40, 0,33 und 0,25 mm entsprechen, wobei die 0,40 mm entsprechende Linie die stärkste ist, zum Herstellen von präpariertem Durchschreibepapier (a) | 0 |
| 38.07 B | Sulfatterpentinöl; Dipenten, roh | 0 |
| 38.07 C | Wurzelterpentinöl; andere terpenhaltige Lösungsmittel aus der Destillation oder einer anderen Behandlung der Nadelhölzer; Sulfitterpentinöl; Pine-Öl | 1,7 |
| ex 38.08 C | Hydroabiethylalkohol | 0 |
| ex 38.19 G | Bortrifluorid-Katalysator, auf Aluminiumoxid fixiert, in Form von Kügelchen mit einem Durchmesser von nicht weniger als 1,4 und nicht mehr als 1,8 mm | 0 |
| ex 38.19 G | Katalysator, bestehend aus Kupferoxid und Dichromtrioxid, in Form von runden Stäbchen mit einer Länge von nicht mehr als 5,0 mm und einem Durchmesser von nicht mehr als 3,6 mm | 0 |

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 38.19 G | Chromtrioxid-Katalysator oder Dichromtrioxid-Katalysator, auf einem Träger aus Siliciumdioxid fixiert, mit einem nach der Stickstoffabsorptionsmethode bestimmten Porenvolumen von 2 $cm^3/g$ oder mehr | 0 |
| ex 38.19 G | Katalysator in Form von runden Stäbchen, mit einer Länge von nicht weniger als 3 und nicht mehr als 6 mm und einem Durchmesser von nicht mehr als 3,8 mm, mit einem Gehalt an Dichromtrioxid von nicht weniger als 18 und nicht mehr als 21 Gewichtshundertteilen und an Aluminiumoxid von nicht weniger als 78 und nicht mehr als 81 Gewichtshundertteilen | 0 |
| ex 38.19 G | Katalysator in Form von Körnern, aus einer auf einen Träger aus Aluminiumoxid fixierten Mischung von Oxiden mit folgender Zusammensetzung:<br>— nicht weniger als 12 und nicht mehr als 20 Gewichtshundertteile Nickel,<br>— nicht weniger als 5 und nicht mehr als 10 Gewichtshundertteile Kupfer,<br>— nicht weniger als 0,5 und nicht mehr als 1,5 Gewichtshundertteile Mangan.<br>Das Porenvolumen beträgt nicht weniger als 0,25 und nicht mehr als 0,95 $cm^3/g$, die augenscheinliche Dichte nicht weniger als 0,5 und nicht mehr als 1,25 | 0 |
| ex 38.19 G | Katalysator in Form von Körnern, die zu 90 Gewichtshundertteilen oder mehr Abmessungen von nicht mehr als 10 Mikrometer aufweisen, aus einer auf einem Träger aus Magnesiumsilicat fixierten Mischung von Oxiden mit folgender Zusammensetzung:<br>— nicht weniger als 20 und nicht mehr als 35 Gewichtshundertteile Kupfer,<br>— nicht weniger als 2 und nicht mehr als 3 Gewichtshundertteile Wismut.<br>Der Katalysator hat eine augenscheinliche Dichte von nicht weniger als 0,2 und nicht mehr als 1,0 | 0 |
| ex 38.19 G | Kobaltoxid-Katalysator, auf Siliciumdioxid fixiert, in Form von Körnern mit einem Durchmesser von nicht mehr als 1,4 mm | 0 |
| ex 38.19 G | Katalysator in Form von Pulver, bestehend aus einem Gemisch von Titantrichlorid und Aluminiumchlorid, das nicht weniger als 20 und nicht mehr als 30 Gewichtshundertteile Titan und nicht weniger als 55 und nicht mehr als 72 Gewichtshundertteile Chlor enthält | 0 |
| ex 38.19 G | Katalysator in Form von Körnern oder Ringen mit einem Durchmesser von nicht weniger als 3 und nicht mehr als 10 mm, auf Aluminiumoxid fixiert, mit einem Gehalt an Silber von nicht weniger als 10 und nicht mehr als 20 Gewichtshundertteilen | 0 |
| ex 38.19 G | Äthyltriphenylphosphoniumacetat-Katalysator, in Methanol gelöst | 0 |
| ex 38.19 G | Kupferchlorid-Katalysator, auf Aluminiumoxid fixiert, zum Herstellen von Dichloräthan aus Äthylen, Salzsäure und Sauerstoff in Festbettreaktoren (sog. Fixed-bed-Verfahren) (a) | 0 |
| ex 38.19 G | Katalysator in Form von Körnern, bestehend aus einer Mischung von Vanadium- und Phosphoroxiden mit einem Gehalt von nicht mehr als 0,5 Gewichtshundertteilen an entweder Lithium oder Kalium oder Natrium oder Cadmium oder Zink, zum Herstellen von Maleinsäureanhydrid aus Butan (a) | 0 |
| ex 38.19 X | Gebrannter Bauxit (feuerfest) | 0 |
| ex 38.19 X | Diosgenin, roh | 0 |
| ex 38.19 X | 4-(6-Fluor-2-methylinden-3-ylmethyl)phenylmethylsulfid, in Toluol gelöst | 0 |

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 38.19 X | Gemisch aus x-Butyl-4,4′-isopropylidendiphenol und x,x′-Dibutyl-4,4′-isopropylidendiphenol | 0 |
| ex 38.19 X | Gemisch aus Nitromethan und 1,2-Epoxybutan | 0 |
| ex 38.19 X | Fabrikationsrückstand mit einem Gehalt an 11-*beta* 17,20,21-Tetrahydroxy-6-methylpregna-1,4-dien-3-on-21-acetat von 40 Gewichtshundertteilen oder mehr | 0 |
| ex 38.19 X | Zwischenerzeugnisse aus der Gewinnung von Salzen des Monensins | 0 |
| ex 38.19 X | Tetramethylammoniumhydroxid, in Methanol gelöst | 0 |
| ex 38.19 X | Zwischenerzeugnisse der Antibiotikagewinnung, erhalten aus der Fermentation von *Streptomyces Tenebrarius,* auch getrocknet | 0 |
| ex 38.19 X | Erzeugnis, hergestellt durch N-Äthylierung von Sisomycin (INN) | 0 |
| ex 38.19 X | Zwischenerzeugnisse der Antibiotikagewinnung, erhalten aus der Fermentation von *Micromonospora purpurea,* auch getrocknet | 0 |
| ex 38.19 X | Cholsäure und 3-*alpha,* 12-*alpha*-Dihydroxy-5-*beta*-cholan-24-säure (Desoxycholsäure), roh | 0 |
| ex 38.19 X | Rohe Gallensäure | 0 |
| ex 38.19 X | Kolloides Diantimonpentoxid | 0 |
| ex 38.19 X | Äthylentetrakis (2-chloräthyl) *bis* (phospat) | 5 |
| ex 38.19 X | Körner oder Granalien, bestehend aus einer Mischung aus Dialuminiumtrioxid und Zirkoniumdioxid mit nicht weniger als 70 und nicht mehr als 78 Gewichtshundertteilen Dialuminiumtrioxid und nicht weniger als 19 und nicht mehr als 26 Gewichtshundertteilen Zirkoniumdioxid | 5,2 |
| ex 38.19 X | Körner oder Granalien, bestehend aus einer Mischung aus Dialuminiumtrioxid und Zirkoniumdioxid mit nicht weniger als 54 und nicht mehr als 62 Gewichtshundertteilen Dialuminiumtrioxid und nicht weniger als 36 und nicht mehr als 44 Gewichtshundertteilen Zirkoniumdioxid | 5,2 |
| ex 38.19 X | Mit einem Gehalt von nicht weniger als 20 und nicht mehr als 25 Gewichtshundertteilen in *Epsilon*-Caprolactam gelöstes Magnesiumbromid-2-oxoperhydroazepin-1-id | 0 |
| ex 38.19 X | Reaktionserzeugnis aus Dibutyldihydrogendiphospat und 1,2-Epoxypropan zur Verwendung bei der Herstellung von Polyurethan in anderer als fester Form (a) | 0 |
| ex 38.19 X | Zwischenerzeugnisse der Antibiotikagewinnung, erhalten aus der Fermentation von *Micromonospora inyoensis,* auch getrocknet | 0 |
| ex 38.19 X | Zwischenerzeugnisse der Antibiotikagewinnung, erhalten aus der Fermentation von *Streptomyces kasugaensis,* auch getrocknet | 0 |

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 38.19 X | Folien, bestehend aus Barium- und Calciumoxiden und entweder Titan- oder Zirkoniumoxiden, gemischt mit Bindemitteln | 0 |
| ex 38.19 X | Mischung von Aminen aus dimerisierten Fettsäuren mit einem mittleren Molekulargewicht von nicht weniger als 520 und nicht mehr als 550 | 0 |
| ex 38.19 X | Durch Fermentation erhaltene Mischung, nicht weniger als 5 Gewichtshundertteile Peptide mit der Struktur der A-Kette des menschlichen Insulins in Form eines Salzes des *S*-Sulfoderivats enthaltend | 0 |
| ex 38.19 X | Durch Fermentation erhaltene Mischung, nicht weniger als 5 Gewichtshundertteile Peptide mit der Struktur der B-Kette des menschlichen Insulins in Form eines Salzes des *S*-Sulfoderivats enthaltend | 0 |
| ex 38.19 X | Lithiumhypochlorit, roh | 0 |
| ex 38.19 X | Reaktionsgemisch, Benzyl-3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-dimethylpropylphthalat und Benzyl-3-isobutyryloxy-2,2,4-trimethylpentylphthalat enthaltend | 0 |
| ex 38.19 X | Mischung von 2-(Perfluoralkyl)äthanthiolen mit perfluorierten Alkylketten von 6 bis 14 Kohlenstoffatomen | |
| ex 38.19 X | Lyophilisierter Extrakt aus den Blutzellen der Krabbe *Limulus polyphemus* (Limulus-Amöbozyt-Lysat) | 0 |
| ex 38.19 X | Gemisch aus (5-Äthyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2 *lambda*$^5$-dioxaphosphoran-5-ylmethyl) methylmethylphosphonat und Bis (5-äthyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2 *lambda*$^5$-dioxaphosphoran-5-ylmethyl) methylphosphonat | 0 |
| ex 38.19 X | Mit einem Anteil von nicht weniger als 19 und nicht mehr als 30 Gewichtshundertteilen in organischen Lösungsmitteln gelöstes Butyläthylmagnesium | 0 |
| ex 38.19 X | Mischung von Oxiden des Bariums, Wismuts, Bleis, Titans und Zinks, in Form von Pulver, mit einem Gehalt an Barium von 5 Gewichtshundertteilen oder mehr und an Titan von 15 Gewichtshundertteilen oder mehr, zur Verwendung als Dielektrikum beim Herstellen von keramischen Mehrschichtkondensatoren (a) | 0 |
| ex 38.19 X | Lithium-Niobat-Scheiben, nicht dotiert | 0 |
| ex 38.19 X | 4-(2-Aminoäthylthiomethyl)-1,3-thiazol-2-ylmethyldimethylamin, in Toluol gelöst | 0 |
| ex 38.19 X | Tetraaluminiumnonamagnesiumdicarbonathexacosa-hydroxidheptahydrat, mit einem oberflächenaktiven Stoff überzogen | 0 |
| ex 39.01 A | Colestipol-Hydrochlorid (INNM) | 0 |

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 39.01 C I a) | Polykondensationserzeugnisse aus Phenol und Formaldehyd, in Form von Hohlkugeln mit einem Durchmesser von weniger als 150 Mikrometer | 0 |
| ex 39.01 C III a) | Reflektierende Polyesterfolien, mit pyramidenartigen Einprägungen versehen | 0 |
| ex 39.01 C III a) | Reflektierende Polyesterfolien, Mikrokügelchen enthaltend | 0 |
| ex 39.01 C III a) | Durchsichtige Polyesterfolien mit einer Beschichtung aus Indium und Silber | 0 |
| ex 39.01 C III a) | Polyesterfolien, mit einer Dicke von nicht weniger als 74 und nicht mehr als 76 Mikrometer, zum Herstellen von flexiblen Magnetplatten (Floppy Discs) (a) | 0 |
| ex 39.01 C III a) | Reflektierende, metallbedampfte Verbundfolien aus einer Lage Polyester und mindestens einer weiteren Lage aus Polyester oder einem anderen Kunststoff, auf einer Seite mit Klebstoff überzogen, auch durch eine vor der Anwendung zu entfernende Folie geschützt | 0 |
| ex 39.01 C III a) | Irisierende Folien aus Polyester und Poly-(methylmethacrylat) | 0 |
| ex 39.01 C III b) | Polyester aus einer Mischung von Isophthalsäure und Terephthalsäure mit 4,4′ -Isopropylidendiphenol | 0 |
| ex 39.01 C III b) | Abfälle und Bruch von mit Wolframverbindungen oder Verbindungen von Metallen der Seltenen Erde beschichteten Polyesterfolien | 0 |
| ex 39.01 C III b) | Poly(oxy-1,4-phenylencarbonyl) in Form von Pulver | 0 |
| ex 39.01 C III b)<br>ex 39.03 B II b) 2,<br>B III b) 4 aa)<br>und B IV b) 4 aa) | Abfälle und Bruch von photographischen (auch kinematographischen) Filmen und Röntgenfilmen | 0 |
| ex 39.01 C IV | Poly(iminomethylen-1,3-phenylenmethyleniminoadipoyl) in Formen im Sinne der Vorschrift 3 b) zu Kapitel 39 | 0 |
| ex 39.01 C IV | Poly(*epsilon*-caprolactam)-Folien, entweder nicht mehr als 10 Gewichtshundertteile Polyäthylen oder nicht mehr als 10 Gewichtshundertteile eines Äthylen-Vinylacetat-Mischpolymerisats enthaltend | 0 |
| ex 39.01 C IV | Poly(*epsilon*-caprolactam)-Folien mit einem Erweichungspunkt von 200 °C oder mehr | 0 |
| ex 39.01 C V | Reflektierende Polyurethanfolien | 0 |
| ex 39.01 C VII | Polyimidfolien und -streifen | 0 |
| ex 39.01 C VII | Poly[oxy(2,6-dibrom-1,4-phenylen)] zur Verwendung bei der Herstellung von Polyamid (a) | 0 |
| ex 39.01 C VII | Poly(oxy-1,4-phenylensulfonyl-1,4-phenylenoxy-1,4-phenylenisopropyliden-1,4-phenylen) in Formen im Sinne der Vorschrift 3 b) zu Kapitel 39 | 0 |

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 39.01 C VII | Flüssiges Poly(oxypropyien) mit 3-(3-[2-[2-(2-Mercaptoäthoxy)äthoxy]äthyltio]-propoxycarbonylamino)-*p*-tolycarbamoyloxy als terminaler Gruppe | 0 |
| ex 39.01 C VII | Poly [oxy-1,4-phenylenisopropyliden-1,4-phenylenoxy-(2-hydroxytrimethylen)] mit einem mittleren Molekulargewicht von mehr als 26 000 in Formen im Sinne der Vorschrift 3 b) zu Kapitel 39 | 0 |
| ex 39.01 C VII | Reaktionsprodukte aus einem Poly(oxyalkylen)polyol mit einer Polycarbonsäure und *epsilon*-Caprolactam | 0 |
| ex 39.02 A | Ionenaustauschermembranen aus fluorierten Kunststoffen zur Verwendung in Chloralkali-Elektrolytzellen (a) | 0 |
| ex 39.02 C I a) | Synthetischer Papierhalbstoff, bestehend aus feuchten Blättern aus nicht cohärenten Polyäthylenfasern (Fibrillen), auch mit Zusatz von Zellulosefasern von nicht mehr als 15 Gewichtshundertteilen, mit in Wasser gelöstem Polyvinylalkohol als Feuchthaltemittel | 0 |
| ex 39.02 C I a) | Synthetischer Papierhalbstoff bestehend aus feuchten Blättern aus nicht cohärenten Fasern (Fibrillen) eines Gemisches aus Polyäthylen und Polyäthylen-Mischpolymerisat, auch mit Zusatz von Zellulosefasern von nicht mehr als 15 Gewichtshundertteilen, mit in Wasser gelöstem Polyvinylalkohol als Feuchthaltemittel | 0 |
| ex 39.02 C II | Mikroporiger Polytetrafluoräthylenfilm, einseitig mit einem wasserdampfdurchlässigen Polymer beschichtet, mit einer Breite von 30 cm oder mehr und einem Quadratmetergewicht von nicht mehr als 50 g | 0 |
| ex 39.02 C II | Mikroporiger Polytetrafluoräthylenfilm mit einer Breite von 30 cm oder mehr und einem Quadratmetergewicht von nicht mehr als 22,4 g | 0 |
| ex 39.02 C II | Poly(l-chlortrifluoräthylen)-Folien | 0 |
| ex 39.02 C IV | Synthetischer Papierhalbstoff bestehend aus feuchten Blättern aus nicht cohärenten Polypropylenfasern (Fibrillen), auch mit Zusatz von Zellulosefasern von nicht mehr als 15 Gewichtshundertteilen, mit in Wasser gelöstem Polyvinylalkohol als Feuchthaltemittel | 0 |
| ex 39.02 C VI a) | Mischpolymerisat ganz aus Maleinsäureanhydrid und Styrol, auch mit einem Anteil an Styrol-Butadien-Blockmischpolymerisat, in Formen im Sinne der Vorschrift 3 b) zu Kapitel 39 | 0 |
| ex 39.02 C VI a) und b) | Mischpolymerisat, ausschließlich aus Allylalkohol und Styrol, mit einer Acetylzahl von 175 oder mehr | 0 |
| ex 39.02 C VII b) | Polyvinylchloridfolien, mit einer Dicke von weniger als 1 mm, beschichtet mit in Klebstoff eingebetteten Glashohlkugeln, deren Durchmesser nicht mehr als 100 Mikrometer beträgt | 0 |
| ex 39.02 C VII b) | Reflektierende Polyvinylchloridfolien, auf einer Seite ganz mit pyramidenartigen Einprägungen versehen | 0 |

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 39.02 C VIII | Vinylidenchlorid-Vinylchlorid-Mischpolymerisat, mit einem Gehalt an Vinylidenchlorid von 79,5 Gewichtshundertteilen oder mehr, in Formen im Sinne der Vorschrift 3 a) oder b) zu Kapitel 39, zum Herstellen von Fasern, Fäden, Monofilen oder Streifen (a) | 0 |
| ex 39.02 C XI | Poly(vinylformal) in Formen im Sinne der Vorschrift 3 b) zu Kapitel 39, mit einem Molekulargewicht von nicht weniger als 10 000 und nicht mehr als 40 000 und einem Gehalt an<br>— Acetylgruppen ausgedrückt in Vinylacetat, von nicht weniger als 9,5 und nicht mehr als 13 Gewichtshundertteilen,<br>— Hydroxyilgruppen ausgedrückt in Vinylalkohol, von nicht weniger als 5 und nicht mehr als 6,5 Gewichtshundertteilen | 0 |
| ex 39.02 C XI | Folien, ganz aus Polyvinylalkohol, mit einem Gehalt an nicht hydrolisierten Acetatgruppen, ausgedrückt in Vinylacetat, von nicht mehr als 2 Gewichtshundertteilen, und an Glycerol als Weichmacher von nicht weniger als 5 und nicht mehr als 15 Gewichtshundertteilen, mit einer Dicke von nicht mehr als 1 mm | 0 |
| ex 39.02 C XI | Polyvinylalkoholfolie, beidseitig beschichtet, mit einer Gesamtdicke von weniger als 1 mm und einer Bruchdehnung (längs oder quer) von 65 % oder mehr | 0 |
| ex 39.02 C XI | Polyvinylalkoholfolie mit einem Gehalt an Polyvinylalkohol von 99 Gewichtshundertteilen oder mehr, unbeschichtet, mit einer Dicke von 1 mm oder weniger | 0 |
| ex 39.02 C XII | Mit einem Gehalt von 55 Gewichtshundertteilen oder mehr in *N,N*-Dimethylacetamid gelöstes Mischpolymerisat aus 2-Diisproropylaminoäthylmethacrylat und Decylmethacrylat | 0 |
| ex 39.02 C XII | Acryl-Methacryl-Mischpolymerisat in Form von Folien mit einer Dicke von nicht mehr als 150 Mikrometer | 0 |
| ex 39.02 C XII | Mischpolymerisat aus Acrylsäure und 2-Äthylhexylacrylat mit einem Gehalt an 2-Äthylhexylacrylat von nicht weniger als 10 und nicht mehr als 11 Gewichtshundertteilen | 0 |
| ex 39.02 C XII | Poly[*N*-(3-hydroxyimino-1,1-dimethylbutyl)acrylamid] | 0 |
| ex 39.02 C XII | Reflektierende Polyacrylfolien, Mikrokügelchen enthaltend | 0 |
| ex 39.02 C XIV a) | Mischpolymerisat aus Vinylchlorid, Vinylacetat und Vinylalkohol, mit einem Gehalt an Vinylchlorid von nicht weniger als 89 und nicht mehr als 92 Gewichtshundertteilen, an Vinylacetat von nicht weniger als 2 und nicht mehr als 6 Gewichtshundertteilen und an Vinylalkohol von nicht weniger als 4 und nicht mehr als 8 Gewichtshundertteilen in Formen im Sinne der Vorschrift 3 a) oder b) zu Kapitel 39 | 0 |
| ex 39.02 C XIV a) | Poly(1-äthyläthylen) (Polybuten-1) in Formen im Sinne der Vorschrift 3 b) zu Kapitel 39 | 0 |
| ex 39.02 C XIV a) | Alternierendes Mischpolymerisat aus Äthylen und Maleinsäureanhydrid, bestimmt zur Verwendung als Verdickungsmittel beim Herstellen von Druckpasten im textilen Pigmentdruck (a) | 0 |
| ex 39.02 C XIV a) | Acrylnitril-Methylacrylat-Mischpolymerisat modifiziert mit Polybutadien-Acrylnitril (NBR) | 0 |
| ex 39.02 C XIV a) | Polyvinylfluorid in Formen im Sinne der Vorschrift 3 b) zu Kapitel 39 | 0 |

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 39.02 C XIV a) | Polytribromstyrol in Formen im Sinne der Vorschrift 3 b) zu Kapitel 39, mit einem Gehalt an Brom von nicht weniger als 66 und nicht mehr als 71 Gewichtshundertteilen | 0 |
| ex 39.02 C XIV a) | Synthetischer Papierhalbstoff, bestehend aus feuchten Blättern aus nicht cohärenten Fasern (Fibrillen), von mit einer organischen Säure modifiziertem Polypropylen, auch mit Zusatz von Zellulosefasern von nicht mehr als 15 Gewichtshundertteilen, mit in Wasser gelöstem Polyvinylalkohol als Feuchthaltemittel | 0 |
| ex 39.02 C XIV a) | Polymerisationserzeugnis aus Acrylsäure und geringen Mengen eines mehrfach ungesättigten Monomeren, bestimmt zur Verwendung als Verdickungsmittel beim Herstellen von Druckpasten im textilen Pigmentdruck oder zum Herstellen von Arzneiwaren der Tarifnummer 30.03 (a) | 0 |
| ex 39.02 C XIV a) | Mischpolymerisat aus Äthylen, Methylacrylat und einem Monomeren, das eine austauschbare, nicht am Kettenende befindliche Carboxylgruppe enthält, auch mit Kieselerde vermischt | 8 |
| ex 39.02 C XIV a) | Polymerisationserzeugnis aus einem (Polybutadien)polyol und zwei Laktamen, *N*,*N*'-vernetzt durch das zweiwertige Acrylradikal einer Dicarbonsäure | 0 |
| ex 39.02 C XIV a) | Mischpolymerisat aus Äthylen und Chlortrifluoräthylen, in Formen im Sinne der Vorschrift 3b) zu Kapitel 39 | 0 |
| ex 39.02 C XIV a) | Mischpolymerisat aus Äthylen, Chlortrifluoräthylen und Hexafluor (2-methylpropen), in Formen im Sinne der Vorschrift 3 b) zu Kapitel 39 | 0 |
| ex 39.02 C XIV a) | Mischpolymerisat aus Tetrafluoräthylen und Hexafluorpropen und einem Anteil von nicht weniger als 1 und nicht mehr als 51 Gewichtshundertteilen an einem der folgenden Füllstoffe:<br>– Bariumsulfat<br>– Dibismuttrioxid<br>– Dibismutcarbonatdioxid<br>– Wolfram<br>in Formen im Sinne der Vorschrift 3 b) zu Kapitel 39 | 0 |
| ex 39.02 C XIV b) | Polyvinylfluoridfolien | 0 |
| ex 39.02 C XIV b) | Reflektierende Folien aus mit Melamin-Formaldehyd modifiziertem Acrylpolymerisat | 0 |
| ex 39.02 C XIV b) | Äthylen-Propylen-Mischpolymerisat in Form von selbstklebenden Streifen, mit einer Breite von nicht weniger als 18 und nicht mehr als 27 mm oder nicht weniger als 58 und nicht mehr als 90 cm und einer Dicke von 1 mm oder weniger, die sich nach einer Dehnung auf das Doppelte ihrer ursprünglichen Länge bei einer Temperatur von 23 °C innerhalb von 2 Minuten auf ihre ursprüngliche Länge – mit einer Toleranz von maximal + 15 % – wieder zusammenziehen | 0 |
| ex 39.02 C XIV b) | Folien aus einem Vinylalkohol-Äthylen-Mischpolymerisat, keine anderen Polymerisations- oder Mischpolymerisationserzeugnisse enthaltend, mit einer Dicke von 1 mm oder weniger und einer Bruchdrehung (längs oder quer) von 65 % oder mehr | 0 |
| 39.03 B V a) 1 | Äthylzellulose, nicht weichgemacht | 0 |
| ex 39.03 B V a) 2 | Alkylhydroxylzellulose | 0 |

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 39.03 B V a) 2 | Hydroxyalkylhydroxyäthylzellulose | 0 |
| ex 39.06 B I | *0*-(2-Hydroxyäthyl)amylopectinhydrolysat | 0 |
| ex 39.07 B V d) | Reflektierende Bänder oder Streifen, bestehend aus einem oberen mit gleichmäßigen pyramidenförmigen Einprägungen versehenen Streifen aus Polyvinylchlorid, der mit parallelen oder gitterartigen Schweißnähten auf einen die Rückseite bildenden anderen Streifen aufgebracht ist, welcher entweder aus Kunststoff oder aus mit Kunststoff beschichtetem Gewebe oder Gewirke besteht | 0 |
| ex 39.07 B V d) | Flächengebilde, bestehend aus zwei aufgespleißten Folien aus Polyäthylen, die kreuzweise, übereinandergelegt und miteinander verschweißt sind | 0 |
| ex 41.02 C | Indisches Kipsleder, ganz, auch ohne Kopf und Füße, mit einem Stückgewicht von mehr als 4,5 und nicht mehr als 8 kg, nur pflanzlich gegerbt, auch weiterbearbeitet, jedoch augenscheinlich zum unmittelbaren Herstellen von Lederwaren nicht verwendbar | 0 |
| 41.03 B I | Schaf- und Lammleder, ausgenommen Leder der Tarifnummer 41.06 und 41.08, anderes Leder, nur gegerbt | 0 |
| 41.04 B I | Ziegen- und Zickelleder, ausgenommen Leder der Tarifnummern 41.06 und 41.08, anderes Leder, nur gegerbt | 0 |
| 41.05 B I | Leder aus Häuten oder Fellen von anderen Tieren, ausgenommen Leder der Tarifnummern 41.06 und 41.08, anderes Leder, nur gegerbt | 0 |
| ex 44.22 B | Fässer und Tröge aus Eichenholz, gebraucht, auch zusammengesetzt; Faßstäbe und Böden, die Teile vorstehender Fässer und Tröge sind | 0 |
| ex 44.28 C | Zündholzstäbchen aus Espenholz (*Populus tremuloides*), zum Herstellen von universell zündbaren Streichhölzern (Überallzünder) (a) | 0 |
| ex 44.28 D II | Schindeln für Dächer oder Fassaden, aus Nadelholz | 0 |
| 45.01 | Naturkork, unbearbeitet, und Korkabfälle; Korkschrot, Korkmehl | 0 |
| 45.02 | Würfel, Platten, Blätter und Streifen aus Naturkork, einschließlich Würfel oder Quader zum Herstellen von Stopfen | 4 |
| ex 48.07 D | Gefärbtes Papier, entweder mit Acrylharz getränkt und mit Polyvinylidenchlorid überzogen oder mit Acrylharz überzogen, mit einer Dicke von nicht weniger als 200 und nicht mehr als 255 Mikrometer und einem Quadratmetergewicht von nicht weniger als 165 und nicht mehr als 185 g | 0 |
| ex 48.21 F II | Papierstreifen in Form von zusammengeklebten Honigwaben, mit einer Höhe von nicht mehr als 13 cm und mit einem Kupferderivat getränkt | 0 |
| ex 49.11 B | Künstlerische Siebdrücke (häufig auch als Serigraphien bezeichnet), vom Künstler signiert und numeriert (von Nr. 1 bis 200) | 0 |

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 49.11 B | Mikroreproduktionen auf undurchsichtigen Trägern, für Datenbanken und Bibliotheken bestimmt (a) | 0 |
| ex 51.01 A | Spinnfäden aus Polytetrafluoräthylen | 0 |
| ex 51.01 A | Polyvinylalkoholgarne, die sich in Wasser bei einer Temperatur von 50 °C auflösen, zur Verwendung bei der Herstellung von Filzen ohne Schuß für Papiermaschinen (a) | 0 |
| ex 51.01 A | Spinnfäden aus einem Mischpolymerisat aus Glykol- und Milchsäure, zum Herstellen von chirurgischen Nähmitteln (a) | 0 |
| ex 51.01 A | Spinnfäden, nur aus Polyglykolsäure | 0 |
| ex 51.01 A | Spinnfäden aus Poly(1,4-dioxanon) | 0 |
| ex 51.01 A | Spinnfäden aus Polyvinylalkohol, nicht texturiert, zum Herstellen von Schläuchen für Druckereiwalzen (a) | 0 |
| ex 51.01 A | Spinnfäden ganz aus aromatischen Polyamiden, hergestellt Polykondensation, von *meta*-Phenylendiamin und Isophthalsäure | 0 |
| ex 51.01 A | Schrumpfbare Bikomponenten-Polyamidspinnfäden, bestehend aus Poly(hexamethylenadipamid) und einem anderen Co-Polyamid, nicht texturiert, ungezwirnt, ungedreht oder mit nicht mehr als 22 Drehungen je m, zum Herstellen von Kniestrümpfen der Tarifstelle 60.03 B I, von Damenstrümpfen der Tarifstelle 60.03 B II a) oder von Strumpfhosen der Tarifstelle 60.04 B III a) I (a) | 0 |
| ex 51.02 A I | Monofile aus Poly(1,4-dioxanon) | 0 |
| ex 51.02 A I | Monofile aus einem Mischpolymerisat aus 1,3-Dioxan-2-on und 1,4-Dioxan-2,5-dion, zum Herstellen von chirurgischen Nähmitteln (a) | 0 |
| ex 51.02 A II | Polyimid-Streifen | 0 |
| ex 51.02 A II | Polytretrafluoräthylen-Streifen, mit einer Bruchdehnung von nicht mehr als 25 % | 0 |
| ex 51.04 A IV | Gewebe aus Polyvinylalkohol-Spinnfäden für Maschinenstickereien | 0 |
| ex 51.04 A IV oder ex 59.08 | Gewebe aus Polytetrafluoräthylen, einseitig beschichtet mit einem Mischpolymerisat aus Tetrafluoräthylen und Trifluoräthylen, mit perfluorierten Alkoxy-Seitenketten mit endständigen Carbonsäure- oder Sulfonsäuregruppen in Form des Kalium- oder Natriumsalzes, auch auf der gleichen Seite mit einer anorganischen Metallverbindung beschichtet | 0 |
| ex 54.03 B I a) | Leinengarne, roh (ausgenommen Garne aus Flachswerg), mit einer Lauflänge je kg von 30 000 m oder weniger, zum Herstellen von gezwirnten Garnen für die Schuhindustrie oder von gezwirnten Kabelabbindegarnen (a) | 1,8 |
| ex 56.01 A | Spinnfasern aus Polytetrafluoräthylen | 0 |

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 56.01 A | Spinnfasern ganz aus aromatischen Polyamiden, hergestellt durch Polykondensation von *meta*-Phenylendiamin und Isophthalsäure, ausgenommen zum Herstellen von Waren der Kapitel 60, 61, 64 und 65 oder von Erzeugnissen, die zum Herstellen dieser Waren verwendet werden (a) | 0 |
| ex 56.01 A | Spinnfasern, mit einem Anteil an Fasern aus Poly(*p*-phenylenterephthalamid) von nicht weniger als 1 und nicht mehr als 15 Gewichtshundertteilen und an Fasern aus aromatischen Polyamiden, hergestellt durch Polykondensation von *meta*-Phenylendiamin und Isophthalsäure, von 85 Gewichtshundertteilen oder mehr | 5 |
| ex 56.01 A | Spinnfäden, nur aus Poly(thio-1,4-phenylen) | 0 |
| ex 56.01 A und ex 59.01 B I | Fasern aus Polyvinylalkohol, auch acetalisiert | 0 |
| ex 56.01 B | Spinnfasern, ganz aus Modal (ISO) | 0 |
| ex 59.03 B | Vliesstoffe aus aromatischen Polyamiden, hergestellt durch Polykondensation von *meta*-Phenylendiamin und Isophthalsäure, als Meterware oder nur quadratisch oder rechteckig zugeschnitten, auch getränkt oder bestrichen | 0 |
| ex 59.03 B | Vliesstoffe aus Polyäthylenfäden, nach dem Spinnvliesverfahren hergestellt (spun bonded), mit einem Quadratmetergewicht von nicht mehr als 115 g und einer Dicke von nicht mehr als 300 Mikrometer, als Meterware oder nur quadratisch oder rechteckig zugeschnitten, auch getränkt oder bestrichen | 0 |
| ex 59.03 B | Verbundvliesstoff aus Polypropylen, bestehend aus einer mittleren Lage aus heißluftgezogenen (meltblown) Fasern, beidseitig beschichtet mit nach dem Spinnvliesverfahren hergestellten Fasern (spun-bonded), mit einer Dicke von nicht mehr als 550 Mikrometer und einem Quadratmetergewicht von nicht mehr als 80 g, als Meterware oder nur quadratisch oder rechteckig zugeschnitten, weder getränkt noch bestrichen | 0 |
| ex 59.03 B | Vliesstoffe aus Polyesterfäden mit Polyacrylaten mit Bindemittel, nach dem Spinnvliesverfahren hergestellt (spun bonded), gepreßt oder geprägt mit einer Gewebestruktur, als Meterware oder nur quadratisch oder rechteckig zugeschnitten, auch getränkt oder bestrichen | 0 |
| ex 59.04 | Kokosgarne zum Herstellen von Teppichen, Fußmatten und ähnlichen Gegenständen (a) | 0 |
| ex 59.08 | Gewebe oder Gewirke, einseitig mit Kunststoff bestrichen oder überzogen, in dem Mikrokügelchen eingebettet sind | 0 |
| ex 59.12 | Gewebe, beschichtet mit in Klebstoff eingebetteten Mikrokügelchen, deren Durchmesser nicht mehr als 75 Mikrometer beträgt, mit einem Quadratmetergewicht von nicht mehr als 550 g | 0 |
| ex 59.17 D | Garne oder Streifen aus Polytetrafluoräthylen, imprägniert, auch geölt und mit Graphitzusatz | 0 |
| 62.03 A I | Säcke und Beutel zu Verpackungszwecken, gebraucht, aus Jutegeweben oder aus Geweben aus anderen textilen Bastfasern der Tarifnummer 57.03 | 0 |

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| 62.03 B I a) | Säcke und Beutel zur Verpackungszwecken, gebraucht, aus Flachs- oder Sisalgewebe | 0 |
| ex 68.16 B | Mikrokügelchen, mit einem Gehalt an Barium und Titan von mehr als 90 Gewichtshundertteilen, ausgedrückt als Bariumoxid und Titandioxid, mit einem Durchmesser von weniger als 100 Mikrometer und einem Refraktionsindex von nicht weniger als 2,1 und nicht mehr als 2,4 | 0 |
| ex 69.03 C und ex 69.14 B | Garne aus verspinnbaren, keramischen Endlosfäden, wobei jeder Faden einen Gehalt an Dibortrioxid von 12 Gewichtshundertteilen oder mehr, an Siliciumdioxid von nicht mehr als 26 Gewichtshundertteilen und an Dialuminiumtrioxid von 60 Gewichtshundertteilen oder mehr aufweist | 0 |
| ex 69.09 B | Träger für Katalysatoren, aus porösen Cordierit- oder Mullit-keramischen Stoffen, mit allgemein rundem, quadratischem, rechteckigem oder ovalem Querschnitt mit parallelen Seiten, die ein Gesamtvolumen von nicht weniger als 240 und nicht mehr als 50 000 ml bei einer Mindestaußenabmessung von nicht weniger als 20 und einer Höchstaußenabmessung von nicht mehr als 1 800 mm haben, mit nicht weniger als 1 durchgehenden Kanal, je 100 mm² die parallel zu der Hauptsymmetrieachse verlaufen; der Gesamt-Kanalquerschnitt beträgt nicht weniger als 10 Prozent und nicht mehr als 80 Prozent des gesamten Flächenquerschnitts | 0 |
| ex 69.09 B | Platten aus Dialuminiumtrioxid und Titancarbid mit den Abmessungen von nicht mehr als 48 × 48 mm, zum Herstellen von Magnetköpfen (a) | 0 |
| ex 70.11 | Glaskolben für monochrome Kathodenstrahlröhren mit einer Diagonalen des Schirms von nicht weniger als 3,8 cm und nicht mehr als 51 cm und mit einem nominalen Durchmesser des Halses von 13, 20, 29 oder 37 mm | 0 |
| ex 70.20 A | Nichttextile Glasfasern mit einem Durchmesser der Fasern von weniger als 4 Mikrometer | 0 |
| ex 70.20 A | Matten, Rollfilze und ähnliche Waren aus nichttextilen Glasfasern mit einem Gewicht pro Quadratmeter von nicht mehr als 120 g und einem Durchmesser der Fasern — ohne Beschichtung — von nicht mehr als 7 Mikrometer, zum Herstellen von Filtermaterial (a) | 0 |
| ex 70.20 B | Garne aus verspinnbaren Endlosglasfäden von 33 tex — mit einer Toleranz von ± 7,5 % — oder einem Vielfachen hiervon, mit einem Durchmesser der Fasern von nicht weniger als 2,5 und nicht mehr als 5,1 Mikrometer, nicht gummifreudig behandelt | 0 |
| ex 70.20 B | Garne aus verspinnbaren Endlosglasfäden, mit Resorcinolformaldehyd behandelt, von nicht weniger als 340 und nicht mehr als 680 tex, mit einem Durchmesser der Fasern von nicht weniger als 12,5 und nicht mehr als 13,5 Mikrometer | 7 |
| ex 70.20 B | Garne aus verspinnbaren Endlosglasfäden von 22 tex mit einem Durchmesser der Fasern von nicht weniger als 4,7 und nicht mehr als 5,5 Mikrometer | 0 |
| ex 70.20 B | Garne aus verspinnbaren Endlosglasfäden von 33, 34 oder 51 tex mit einer Toleranz von ± 7,5 % — oder einem Vielfachen davon, mit einem Durchmesser der Fasern von nicht weniger als 5,8 und nicht mehr als 7,4 Mikrometer | 0 |
| ex 74.05 B | Tafeln und Platten aus Polytetrafluoräthylen, mit Aluminiumoxid oder Titandioxid als Füllstoff oder mit Glasfasergewebe verstärkt, auf beiden Seiten mit einer Kupferfolie versehen | 0 |
| ex 75.04 A | Rohre aus nicht legiertem Nickel mit einem Reinheitsgrad von nicht weniger als 99 Gewichtshundertteilen, mit einer Abweichung von der Geradlinigkeit von nicht mehr als 1 mm auf 150 cm und mit einem Außendurchmesser | |

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 75.04 A *(Fortsetzung)* | — von nicht weniger als 213,36 mm und nicht mehr als 214,00 mm<br>oder<br>— von nicht weniger als 209,95 mm und nicht mehr als 210,59 mm<br>oder<br>— von nicht weniger als 168,28 mm und nicht mehr als 168,78 mm | 0 |
| 76.01 B I b) | Andere Bearbeitungsabfälle aus Aluminium (einschließlich der fehlerhaften oder bei der Be- oder Verarbeitung unbrauchbar gewordenen Werkstücke) | 0 |
| ex 76.03 | Rechteckige Bänder aus Aluminiumlegierungen, in Rollen, weder lackiert, verniert, mit Farbe bestrichen noch mit Kunststoff beschichtet, mit nicht weniger als 18 und nicht mehr als 23 Gewichtshundertteilen Zinn und nicht weniger als 0,7 und nicht mehr als 1,5 Gewichtshundertteilen Kupfer und — soweit vorhanden — anderen Metallen mit jeweils niedrigeren Gewichtshundertteilen als Kupfer mit einer Breite von nicht weniger als 75 mm und nicht mehr als 230 mm und einer Dicke von nicht weniger als 2,9 mm und nicht mehr als 6,5 mm | 0 |
| ex 77.02 | Magnesiumplatten, geschliffen und poliert, auf einer Seite mit nicht lichtempfindlichem Epoxyharz überzogen, mit den Abmessungen von nicht mehr als 1 500 × 2 000 mm | 0 |
| ex 81.03 B | Tantaldraht, unlegiert mit einem Durchmesser von nicht weniger als 0,2 mm und nicht mehr als 0,5 mm, zum Herstellen von Kondensatoren (a) | 0 |
| ex 81.04 G I | Elektrolytisches Mangan, mit einem Reinheitsgrad von mindestens 99,7 Gewichtshundertteilen, für die chemische Industrie (a) | 0 |
| ex 81.04 G I | Elektrolytisches Mangan, mit einem Reinheitsgrad von mindestens 99,7 Gewichtshundertteilen, zum Herstellen von NE-Metallegierungen (a) | 0 |
| ex 81.04 K I | Bearbeitungsabfälle und Schrott von Titan | 0 |
| ex 81.04 K I | Titanschwamm | 0 |
| ex 84.18 C II b) | Teile von Apparaten zum Filtrieren von Gasen aus Gasgemischen, bestehend aus einem durchlässigen Hohlfaserbündel, das an einem Ende einen Kunststoffblock durchquert und am anderen Ende versiegelt ist, das Ganze befindet sich in einem — auch perforierten — Metallgehäuse mit einer Gesamtlänge von nicht weniger als 300 und nicht mehr als 3 700 mm und einem Durchmesser von nicht mehr als 350 mm | 0 |
| ex 84.18 C II b) | Teile von Apparaten zum Filtrieren oder Reinigen von Wasser durch Umkehr-Osmose (Reverse-Osmosis), im wesentlichen Membranen aus Kunststoff auf einem textilen Träger enthaltend, die um ein perforiertes Kunststoffrohr gewickelt sind; das Ganze befindet sich in einem Gehäuse aus Kunststoff | 0 |
| ex 84.18 C II b) | Teile von Apparaten zum Filtrieren oder Reinigen von Wasser durch Umkehr-Osmose (Reverse-Osmosis), bestehend aus einem durchlässigen Hohlfaserbündel aus Kunststoff, das an einem Ende in einem Kunststoffblock eingebettet ist und am anderen Ende einen Kunststoffblock durchquert; das Ganze befindet sich in einem Gehäuse aus Kunststoff | 0 |
| ex 84.31 A | Saugwalzenmäntel, nicht gebohrt, in Form von Rohren aus legiertem Stahl, mit einer Länge von nicht weniger als 5 207 mm und einem Außendurchmesser von nicht weniger als 754 mm, für Maschinen zum Herstellen von Papier oder Pappe (a) | 0 |
| ex 84.51 A | Blindenschriftschreibmaschinen | 0 |

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

| Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz % |
|---|---|---|
| ex 84.51 A | Elektronische Taschen-Schreibmaschinen für Behinderte, die mittels Drucktasten und thermischem Schreibkopf ein Schriftband bedrucken und ausgeben | 0 |
| ex 85.21 E | Gitter, Kathoden und isolierte Wolframdrahtspiralen zum Herstellen von Elektronenkanonen für *monochrome* Kathodenstrahlröhren (a) | 0 |
| ex 85.22 C II | Elektromagnetische Anzeige, bestehend aus 7 Elektromagneten, die durch Restmagnetismus des Magnetkerns dafür sorgen, daß die letzte Angabe verfügbar bleibt, 7 drehbaren, lichtreflektierenden Segmenten, die jeweils mit einem Stahlmagneten verbunden sind. Die Anzeige ist in einem Gehäuse mit den Abmessungen von nicht mehr als 28 × 36 × 50 mm | 0 |
| ex 85.22 C II | Tragbares Braille-Schreib- und Lesegerät mit den Abmessungen von nicht mehr als 11 × 24 × 36 cm, mit einer Anzeige- und Magnetbandkassettenaufnahmevorrichtung, einer elektromechanischen Braille-Schreibmaschinentastatur, einem elektromechanischen Braille-Anzeigegerät mit 20 Stellen, einem Mikrophon und Lautsprecher | 0 |
| ex 90.01 A II | Achteckige Fresnelsche Linsen aus Acrylharz, nicht gefaßt, zum Einbau in Überkopfprojektoren (a) | 0 |
| ex 90.01 B | Polarisierender Film, auf eine oder zwischen zwei Unterlagen aus durchsichtigem Material aufgebracht | 0 |
| ex 90.19 A III | Gefäßprothesen, deren größte Öffnung einen Innendurchmesser von 8 mm oder weniger aufweist | 0 |
| ex 90.19 A III | Gefäßprothesen aus einem schlauchförmigen Spinnstoffträger, umhüllt mit tierischen Kollagen | 0 |
| ex 90.19 A III | Herzklappen und ihre Teile | 0 |
| ex 90.19 B I | Empfänger für Schwerhörigengeräte, in einem Gehäuse mit den Abmessungen — ohne Anschlußstücke — von nicht mehr als 5 × 6 × 8 mm | 0 |
| ex 90.19 B II | Lesegeräte für Blinde, die über eine Miniaturkamera mittels Phototransistoren Buchstaben auf ein sogenanntes Abtastfeld mit piezoelektrischen Stiften übertragen, und ihre Teile und Zubehör | 0 |
| ex 91.11 C II und/oder ex 91.11 F | Einheit, bestehend aus einer gedruckten Schaltung mit einem Quarzschwinger und jeweils mindestens einer Uhrenschaltung und einem Kondensator, mit einer Dicke von nicht mehr als 5 mm, zum Herstellen von Waren des Kapitels 91 (a) | 0 |
| ex 91.11 F | Einheit, bestehend aus einer gedruckten Schaltung, auf der eine Uhrenschaltung angebracht ist, mit einer Dicke von nicht mehr als 5 mm, zum Herstellen von Waren des Kapitels 91 (a) | 0 |
| ex 98.04 A II | Schreibspitzen aus Kunststoff, keine Fasern enthaltend, mit einem Innenkanal | 0 |
| ex 98.10 B | Reibrädchen, auch mit Außenhalterungen, zum Herstellen von nicht nachfüllbaren Gas-Taschenfeuerzeugen (a) | 0 |
| ex 98.10 B | Piezo-Zündmechanismus | 0 |

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.